講座



Material Property and Simulation Methods Applicable to Laser Produced Plasmas in the New Density and Temperature Region

1. はじめに

1. Introduction

 大道博行,佐々木 明¹⁾
 DAIDO Hiroyuki and SASAKI Akira¹⁾
 日本原子力研究開発機構敦賀本部レーザー共同研究所,¹⁾日本原子力研究開発機構量子ビーム応用研究部門 (原稿受付:2013年4月25日)

1.1 はじめに

読者の中には標記タイトルの"新しい"という言葉に奇 異な印象を持たれる方も少ないと思われる.本章では今な ぜ"新しい"か、を含めて本講座の趣旨を述べることにす る. さて1960年, 最初のレーザー発振が報告されてから, すぐにレーザーを様々な物質に照射する研究が始まってい る[1]. 高出力レーザーを気体に照射すると、レーザー電 場により絶縁破壊が起こり可視光のスパークが観測さ れ、1963年パリで開催された量子エレクトロニクス国際会 議(IQEC)で大きな話題となった[2]. その直後, 高強度 レーザーを固体物質に照射しプラズマが発生することが報 告されている[3]. これらの成果は、種々枝分かれして、 それぞれ独自の発展を遂げつつある高出力レーザーの応用 研究の原点と言っていいであろう.一方,レーザー自身の 高性能化も進んだ.モード同期法等,周波数域,空間周波 数域のモード制御技術, または時間・空間域の形状制御法 が発展し、空間的には単一モードで波長程度の集光サイ ズ、時間的には広いスペクトルモード間の高い位相相関に より極短パルスで高いピーク出力のものが現れ、レーザー 集光技術の高性能化,目的に応じた多様化と相まって物質 への高度な照射も可能になってきた[4,5]. さらに1985年 のチャープパルス増幅法の発明[6]により時間幅フェムト 秒, ピークレーザー強度>数 TW のレーザーが信頼性の高 い固体レーザー技術により製作可能となった. 1990年代に 入り小型実験室規模の高強度場科学研究[7]を筆頭に,多 くの科学分野で用いられるようになった.それらの中で, フェムト秒パルスによるナノ構造創製や3次元加工技術な どは,近い将来の産業利用をめざしてレーザー照射実験が 活発に行われており,同時に理論的研究も進んでいる [8-10].

一方、連続発振のレーザーも溶接、溶断の用途を中心に 高性能化が進んでいる.近年、レーザーダイオード、増幅 器の励起法、冷却法の高性能化により薄型ディスクレー ザー[11],ファイバーレーザー[12]が相次いで高出力化に 成功した. それらの小型, 高効率, シンプルな構成, メン テナンスフリー、光学素子の高耐力化等の性能が評価さ れ、自動車等の工場生産に大規模に用いられるようになっ てきた[13].ところで連続したレーザー光の照射は他の熱 加工源と単純な比較はできない、これまで開発された多く の優れた熱加工技術と比較しても、レーザー法には他の熱 源ではありえない時間・空間的に高速、繊細な変調が可能 であることから,連続光源,準連続光源として新たな加工 コンセプトのもと、新たな加工分野を形成しつつある [14,15]. すなわち高度に制御されたレーザー照射により 物質の様々な時間・空間スケールの応答に対応した自在な 照射の下で革新的な加工が可能になりつつある. この観点 に基づくとフェムト秒パルスレーザーやミリ秒パルスレー ザーを用いた穴あけ加工にその先駆的な適用例[16-18]が あるが、時間・空間的に異なった照射領域における加工メ カニズムの究明と、その知見に基づくレーザー照射の最適

Applied Laser Technology Institute, Japan Atomic Energy Agency, Tsuruga, FUKUI 914-8585, Japan,

¹⁾ Quantum Beam Science Directorate, Japan Atomic Energy Agency, KYOTO 619-0215, Japan

authors' e-mail: daido.hiroyuki@jaea.go.jp, sasaki.akira@jaea.go.jp

化は今後,益々重要な課題になると考えられる.以上述べ てきた高出力レーザーを物質に照射することによる物質の 改変には、アブレーションとともに起こる電離過程が大な り小なり必ず含まれており、この意味でレーザープラズマ が研究対象になる.このようにレーザープラズマは近年, 科学研究,産業の中で様々な分野に広がりつつある.その 一方で、レーザー照射により有用な現象がみつかると,経 験的事実の積み重ねによる技術開発が一気に進み,現象の 解明が追いつかないといった現実も見受けられる.

本講座では、この章に引き続き各分野の専門家による レーザープラズマの新しい展開が紹介される.レーザーと 物質との相互作用に関する古くから調べられてきた知見、 ならびに最近得られた知見を整理し、広がりつつあるレー ザープラズマの境界領域が"新しい領域"における"新し い知見"、"新しい課題"として浮かび上がってくることを 期待したい.このようなプラズマ生成の科学的知見に基づ いた高度に制御されたレーザー照射法の開拓は学術的意義 が大きいだけでなく、その知見を基礎にしたレーザー加工 等の産業利用に今後大きな発展が見込める.この点を強調 する目的で、あえて"新しい"を講座のタイトルに使用し た.

1.2 広がりつつあるレーザープラズマの境界領域 1.2.1 ナノ秒レーザーパルスによるプラズマの発生

まず、レーザー核融合で想定されているような、時間幅 がナノ秒のレーザーでターゲット物質を照射する場合を考 え、これまで標準的に用いられてきた理論に基づいて、そ のプラズマ生成過程について検討する.一般にレーザー照 射によりターゲット表面からプラズマが噴出する時、入射 するレーザーのパワーと噴出するプラズマが持ち去るパ ワーとの間に瞬時に釣り合いが成り立つことが本質と考え ることにより、現象は単純化され、定常的なターゲット物 質の噴出と、一次元的なプラズマの温度、密度の分布を考 えることができる.電子熱伝導の効果によって、プラズマ の温度は膨張部において一様となり、密度は、等温膨張の 相似解に従い、ターゲット表面から指数関数的に減少する 分布を持つ[19,20].高温のプラズマがターゲット表面か ら噴出する反作用(ロケット作用)として、アブレーショ ン圧力が発生する[21]. このような考え方は,慣性核融合 のターゲットの爆縮の考え方の基本になり,レーザープラ ズマの多くの現象を説明するのに成功を収めてきた.

1.2.2 レーザー照射初期の物理過程

現在では、1.1はじめにで示したように、様々な加工技術 など多くの分野でレーザープラズマが深く関与している. このような応用において、固体物質がレーザー照射を受け ると、液相、気相の状態への相転移や、電離過程を伴って プラズマ化する.精度を要求する高度な加工では、溶融、 蒸発、凝固と関連するプラズマの過程を詳しく理解して制 御することが重要となる.

レーザー核融合の実験において、レーザー光の照射初期 のビーム強度パターンに不均一性が存在すると、プラズマ の噴出による表面の質量分布の不均一性が生じる.これは イニシャルインプリントと呼ばれ、レーザー核融合の高密 度爆縮にとって有害な効果をもたらすことが示されている [22].このようなプラズマの現象は、レーザー照射初期の ごく短時間に起こる過渡的現象で、かつ空間スケールも微 細な現象であることから、その実験的な解析にはしばしば 特別な技術が必要である。例えば、イニシャルインプリン ト現象については、レーザー照射初期のアブレーションに 伴うきわめてわずかな質量の変化を軟X線レーザーによる プローブ計測で捉える試みが行われている[23,24].

一方,このようなプラズマに着目した理論研究も行われ ている.Anisimovらは,アブレーションの初期過程におけ る熱伝導の性質に注目し,ターゲット物質を,熱伝導の特 性や,レーザーが照射された時の初期電子の生成および レーザー光の吸収の特性ごとにカテゴリーに分けて解析 し,溶融や蒸発が起こる界面に不安定性が起こる可能性を 理論的に指摘した[5].このようなプラズマの特性をシ ミュレーションするには,相転移過程の温度や密度の3次 元的空間分布の急速な変化や,その確率論的な振る舞いを 取り扱うことが必要になる.

図1はプラズマ生成過程の一例を示す.レーザー照射に より、はじめに、多光子過程やレーザー電界による電離で 自由電子が生成し、自由電子はレーザーの電界でさらに加 速され、固体中の格子と衝突しターゲット物質は加熱され る.次に、ターゲット物質は溶融、蒸発し、一部プラズマ



図1 レーザー照射によるプラズマ生成のメカニズム.

化した高温の粒子が発生し、それらの粒子とレーザー光の 相互作用によって、密度の低下したガス状のプラズマプ ルームが生成する.レーザー照射後のスポットにみられる 痕跡や、発生するデブリなどから、照射領域とその周辺で 複雑な物理過程が存在することが類推される.

なお、図1のような、表面の構造形成や粒子発生などの 現象は、レーザー照射プラズマにおいて常にこのような順 序で発生するというよりは、むしろ、レーザー核融合、 EUV 光源、レーザー加工それぞれの照射条件において、異 なった現れ方をする。レーザー光で固体ターゲットを照射 した場合、強度の強いスポット中心部ではプラズマが生成 する一方で、周辺部からは、溶融したターゲット物質のデ ブリとしての放出が起こる場合もある.

実際、矢部らはナノ秒レーザーをアルミニウムターゲッ トに照射して得られる照射領域からのデブリの空間分布の 観測結果と、独自に開発したシミュレーションコードによ る結果を比較対比することにより、レーザープラズマとそ の周辺の複雑な過程の説明に成功している[25]. 関連する 研究として、ナノ秒レーザー照射により、例えば材料表面 に流した水の中にプラズマを生成し、その圧力により材料 の応力分布を制御することを目的にしたピーニングへの応 用がある[26,27]. また長年に亘り研究されてきた EUV (極端紫外) 光源の最近の話題の一つに, 短パルスプリパル スとナノ秒メインパルスを組み合わせた照射による高効率 EUV 光発生技術がある[28]. これは1990年代, 軟 X 線・ EUV レーザーで用いられ、発振波長を広げ、高効率化に貢 献した手法と同様なものであり[29],低強度プリパルス照 射で放出されるプラズマや中性粒子とメインパルスとの相 互作用を,望まれるパラメータのレーザープラズマの高効 率生成のために積極的に利用したものである.

1.2.3 レーザーによる溶接・切断技術の物理過程

溶接,切断などのレーザー加工においては、ターゲット 物質の溶融,蒸発とデブリの発生などが、空間的に移動し ながら、時間的にはできるだけ定常的に起こるように、 種々の条件を設定することが求められる.連続出力レー ザーによる溶接現象のX線管を用いたリアルタイム観測 [30]や大型放射光施設 SPring-8を用いた同様の研究もあ る[31].また第一原理計算による金属の溶融・蒸発現象の 初期過程のシミュレーション[32],伝熱特性のシミュレー ション[33],流体モデルによる伝熱・対流シミュレーショ ンなどが行われている[34,35].

1.2.4 超短パルスレーザー

レーザーのパルス幅,フェムト秒から数ピコ秒までの超 短パルスレーザー照射による微細構造の生成に関しても研 究は進んでいる[36,37].例えば波長以下の空間的構造形 成やナノメートルサイズの粒子発生の観測があり,生成機 構の検討も行われている[9].一方,主として超高速過程 の直接観測の観点から,レーザー照射面の極微小な変位の 測定を可能にしたパルス幅数ピコ秒の軟X線レーザーを用 いた干渉計測[38],レーザー照射により物質中の格子の崩 れていく様子[39,40]や溶融の初期過程の直接観測[40]が レーザープラズマからの超短パルス内殻遷移X線を用いた 時間分解 X 線回折によって観測されている.また,超短パ ルス高強度レーザー照射によって地上では容易に発生でき ない物質状態の発生が可能になる.例えば固体の炭素に レーザーを照射することにより瞬時に液体にする.同時に 反射率の測定を行い,電気抵抗を評価する実験が行われ話 題になったことがある[41,42].超短パルスレーザーの固 体への照射により,固体の規則的構造を保ちつつ,電離を 起こしている状態,すなわち固体とプラズマの両方の性質 を有する Warm Dense Matter [43]のような地上ではきわめ て特殊な状態を生成することも可能であり,種々工夫を凝 らした研究が行われている.このようにレーザーにより 様々なプラズマを自在に生成することが可能になり,多種 多様な研究が可能になっている.これも研究の境界が"新 しい領域"に広がりつつあることを示している.

1.3 本講座の対象

1. Introduction

1.3.1 広い範囲のレーザープラズマ相互作用

図2にはレーザーの時間幅を横軸にして、本講座のテーマをリストアップした.まず非熱的領域に注目してみよう.パルス幅数ピコ秒以下の超短パルスレーザーの場合は2の液体を通過することなく、直接物質が剥がれていくことなども提唱されている[44].またそれを用いて、ナノメートルスケールの微細構造形成や微粒子生成などの新しい応用が可能になり[45,46],固体物性の立場でのモデリング、シミュレーションも行われるようになった[47].

レーザー照射時に熱伝導が支配的になる高強度レーザー 光の固体ターゲット照射においては,照射部の高密度・高 温プラズマと同時に固体,液体状態のデブリの放出が観測 されている.応用分野の必要に応じてレーザー照射時間に 比べ時間スケールの桁違いに長い周辺部の溶融,剥離現象 も物理的に把握していくことが求められている.連続光を 用いたレーザー加工(溶接,切断)においては固体の溶融, 蒸発がほぼ連続的かつ定常的に起きており,パルスレー ザー照射における照射周辺部の物理過程と重なる部分や異



図2 本講座で取り扱う課題を,照射レーザーの強度とパルス幅 および,現象のタイムスケールに対するマップ上で示す.

なる部分など、興味深い課題も様々浮かび上がってくる. 有意義な課題抽出のためにも、これら各レーザー照射時間 幅と対応する物質の特徴的な時間応答を整理しておくこと は価値があると思われる[48].一方,磁場閉じ込め核融合 の核融合プラズマ密度を上げることが目的であるペレット インジェクション技術における射出ペレット(固体物質) とその周囲の高温プラズマによる溶発過程は、中性ガスの 熱的シールドによる比較的緩やかな熱の移動による溶融・ 蒸発過程とするモデルがよく成り立っているとされている [49]. 固体からプラズマへ転移していく過程にはレーザー 加熱と共通する部分、共通しない部分があり、それらを比 較対比することによって有用な知見が得られることが期待 される. 例えばレーザー加熱による固体と液体, 気体境界 における熱伝導など、インジェクションにおける物理過程 との比較は興味深い. この研究の主たる目的である核融合 燃料の供給とともに, それを用いたプラズマの計測技術と しての研究開発が活発に進められており[49,50],広い意 味での熱源によるプラズマ生成に、異分野間の交流による "新しい知見"がもたらされることを期待したい.

1.3.2 シミュレーションの対象

ここで述べた諸点に留意して周辺分野を眺めると, 固体 物性や,熱流体の立場での,レーザーと物質の相互作用の 研究も活発に行われている.図1にもう一度着目する.お よそパルス幅数ピコ秒以下の領域では,非熱的な相互作用 によって初期のプラズマが生成する.この過程について, 第一原理に基づくポテンシャルの仮定のみに基づく分子動 力学からマクロな物理量の関係を物理の法則に基づいて把 握する所謂現象論的な手法も含むモデリングが行われてい る[32]. ミリ秒より長いパルス幅では、ターゲット物質の 溶融、蒸発を経て、固体物質が連続的にプラズマ状態へと 遷移する過程のモデル化、シミュレーションが行われてい る[25,35]. これらの計算は、実験と連携し、観測結果と比 較しながら行うことが可能であり、それを通じて、各領域 のより深い理解と、より広い応用可能性を展望することが 可能になるものと期待される. プラズマ物理学が対象とす る広い温度, 密度領域の中における, 本講座の対象領域を 図3に示す.地上で通常見ることのできる固体密度周辺の 広い温度範囲を取り上げており, 古くからある対象であり ながら、"新しい観点"、"新しい計測"、"新しいシミュ レーション手法"を導入することにより、"新たな挑戦" の対象となっていることを講座の中で示していきたい.

1.4 本講座の構成

以上の問題意識の下に、本講座では、以下の構成にした. 本講座の目的および取り上げる対象を第1章で論じ、以後 の各章の基礎となる物理を第2章で論じるとともに、実験 と緊密に結びついたシミュレーションを中心に種々の分野 の事例を第3章から第5章にわたり紹介し、第6章でまと めを行い、同時に今後の課題等を提示する.各章の表題と 執筆者は以下のとおりである.

- 1. はじめに (大道, 佐々木) 本章
- 2. プラズマの状態方程式(モア)



- 図3 プラズマ物理学の種々の研究課題が対象とする温度,密度 範囲と、今回の特集で主に取り扱われるレーザープラズマ の範囲および,各章で議論される代表的な応用のうち,輻 射流体が問題となるEUV光源や,熱流体として扱われる加 工(切断,溶接)が対象とする領域を示す.
- EUV 光源や ICF におけるレーザープラズマ相互作用 の初期過程(砂原)
- 4. 固体物性からみたレーザーアブレーション(富田)
- 5. レーザー加工のシミュレーション (村松,山田,山下, 杉原)
- 6.磁場閉じ込め核融合におけるペレット溶発の物理と応用(坂本)
- レーザープラズマ相互作用において問題となる物質状態に関する考え方のまとめ(米田)

参考文献

- [1] T.P. Hughes, *Plasma and Laser Light* (Adam Hilger Ltd, London, 1975), and references cited theirin.
- [2] P.D. Maker et al., Proc. 3rd International Conference on Quantum Electronics, Paris (New York, Columbia Univ. Press, 1964) Vol. 2.1559.
- [3] F. Haught and D.H. Polk, Phys. Fluids 9, 2047 (1966).
- [4] M. von Allmen and A. Blatter, *Laser-Beam Interactions with Materials*, 2nd Edition, (Springer Berlin, Heidelberg, New York, 1995).
- [5] S.I. Anisimov and V.A. Khokhlov, *Instabilities in Lase-Matter Interaction* (CRC Press Bocca Raton, London, Tokyo, 1995).
- [6] D. Strickland and G. Mourou, Opt. Commun. 56, 219 (1985).
- [7] 例えば大道博行:レーザー研究 31,698 (2003).
- [8] 橋田昌樹 他:レーザー研究 33,514 (2005).
- [9] 橋田昌樹 他:第78回レーザ加工学会講演論文集 87 (2012).
- [10] P. Balling and J. Schou, Rep. Prog. Phys. 76, 036502 (2013).
- [11] A. Giesen and J. Speiser, Proc. SPIE 8547, 85470B (2012).
- [12] D.J. Richardson et al., J. Opt. Soc. Am. B27, B63 (2010).
- [13] 佐藤彰生: 第78回レーザ加工学会講演論文集 25 (2012).
- [14] 片山聖二:レーザ加工学会誌 13,259 (2006) および 片山聖二:レーザ加工学会誌 15,35 (2008).
- [15] 新井武二:レーザ加工学会誌 15,255 (2008).
- [16] B.N. Chichkov et al., Appl. Phys. A63, 109 (1996).
- [17] A.H. Khan et al., Optics and Lasers in Engineering 44,826

Lecture Note

(2006).

- [18] C. Momma et al., Opt. Commun. 128, 101 (1996).
- [19] 例えば M. Murakami, Phys. Plasmas 12, 062706 (2005).
- [20] M. Murakami *et al.*, Phys. Plasmas **12**, 062706 (2005)およ びその参考文献を参照.
- [21] 例えば B.H. Ripin et al., Phys. Fluids 23, 1012 (1980).
- [22] C.J. Pawley et al., Phys. Plasmas 6, 565 (1999).
- [23] M.H. Key *et al.*, J. Quant. Spectroc. Radiat. Transfer 54, 221 (1995).
- [24] D.H. Kalantar et al., Phys. Rev. Lett. 76, 3574 (1996).
- [25] 矢部 孝:レーザー研究 26,788 (1998).
- [26] 佐野雄二 他:レーザー研究 26,793 (1998).
- [27] 佐野雄二:表面技術 60,698 (2009).
- [28] T. Akiyama *et al.*, J. Plasma Fusion Res. SERIES, Vol. 8, 496 (2009).
- [29] H. Daido, Rep. Prog. Phys. 65, 1513 (2002).
- [30] 松縄朗, 片山聖二: レーザー研究 26,783 (1998).
- [31] T. Yamada et al., Proc. 12th Int. Symp. Laser Precision Microfabrication (2011) paper number #11-055 Tu3-O-7, Att 0091
- [32] 大村悦二, 宮本 勇:レーザー研究 26,800 (1998).
- [33] 例えば,大中逸雄:コンピューター伝熱・凝固解析入 門(丸善,1985).
- [34] 田中 学 他: プラズマ・核融合学会誌 87,522 (2011).



芯 どう ひろ ゆき

1981年3月大阪大学大学院工学研究科博士 課程修了.工学博士.大阪大学レーザー核 融合研究センターにて超高出力レーザーを 用いたX線レーザー等の研究に従事.2000

年より(特)原研関西研(現在(独)原子力機構原子力機構・関 西光科学研究所)にて極短パルス超高強レーザーを用いた高 強度場科学研究,高エネルギー粒子発生とその利用研究に従 事した.2009年より新設された(独)原子力機構・敦賀本部 レーザー共同研究所にてレーザーの原子力エネルギー開発へ の応用とそれを通じた産業利用,それらの基盤的研究および データベース構築をめざした研究開発に従事している.

- [35] 杉原健太 他:第25回数値流体力学シンポジウム C08-1, 2011年12月 大阪大学.
- [36] 平尾一之,邸建栄編:フェムト秒テクノロジー-基礎 と応用(化学同人,2006)
- [37] 板倉政明:第77回レーザー加工学会講演論文集(2012 年5月) p.129.
- [38] 富田卓朗 他:レーザー研究 40,592 (2012).
- [39] A. Rousse *et al.*, Rev. Mod. Phys. **73**, 17 (2001).
- [40] K. Sokolowski-Tinten and D. von der Linde, J. Phys.: Condens. Matter 16, R1517 (2004).
- [41] D.H. Reitze et al., Phys. Rev. B45, 2677 (1992).
- [42] N. Bloembergen, Nature 35, 110 (1992) (News and Views).
- [43] 米田仁紀: プラズマ・核融合学会誌 81,172 (2005).
- [44] B.J. Demaske et al., Phys. Rev. B82, 064113 (2010).
- [45] 藤田雅之, 橋田昌樹: プラズマ・核融合学会誌 81, Suppl., 195 (2005).
- [46] H. Azuma et al., Jpn. J. Appl. Phys. 43, L1172 (2004).
- [47] D. Perez and L. J. Lewis, Phys. Rev. B67, 184102 (2003).
- [48] A.H. Zewail and J.M. Thomas, *4D Electron Microscopy* (Imperial College Press, 2010) page 3.
- [49] 坂本隆一,星野光保:プラズマ・核融合学会誌 83,560 (2007).
- [50] N. Tamura et al., プラズマ・核融合学会誌 78,837 (2002).



· 佐々木 明

日本原子力研究開発機構量子ビーム応用研 究部門研究副主幹.主な研究分野:レー ザー生成プラズマを用いた EUV 光源や X 線レーザーの原子過程,プラズマの複雑性

の数理モデルとシミュレーションの研究を行っています.趣味:再生可能エネルギーの研究.かつて同じように夢のエネ ルギーといわれながら,置くだけで発電し,燃料不要,騒音, 排気ガスもなく,既存のエネルギー源と考えがまったく違う エネルギー源の出現に関心を持っています.

講座 レーザー生成プラズマの新しい温度,密度領域における物性とシミュレーション 2. レーザープラズマ相互作用における状態方程式

2. Equation of State for Laser-Matter Interaction

MORE Richard Lawrence Berkeley National Laboratory (原稿受付:2013年4月25日)

本章では、高強度レーザーで照射された固体媒質の爆発的な膨張過程を記述する、状態方程式 (Equation of State: EOS) について、その研究の歴史や現状、今後の課題について述べる.状態方程式は、物質がどのように加熱され、蒸発、電離するか、熱エネルギーがどのようにプラズマの膨張の運動エネルギーに変換されるかを、シミュレーションで予測するために欠かせない情報である.

Keywords:

equation of state, dense plasma, laser plasma, ablation, evaporation

2.1 はじめに

この講座では、レーザープラズマ相互作用における状態 方程式(Equation of State: EOS)とは何か?何のために用 いられるか?ここでいう状態方程式が、大学で学ぶ、以下 の簡単な理想気体の状態方程式、

$$pV = Nk_{\rm B}T, \qquad (1a)$$

$$E = \frac{3}{2} N k_{\rm B} T \,, \tag{1b}$$

とどのように違うかや,理想気体の状態方程式(1)の起 源,およびその限界について考える.ここで,pは気体の圧 力,V は気体が入っている容器の体積,N は容器の中の気 体分子の数,E は気体分子の運動エネルギー,k_Bはボルツ マン定数,T は温度である.

2.1.1 高温の空気

1804年にナポレオン・ボナパルトは,パリの新しい科学 技術の高等教育機関を軍の支配下に置き,その名称をエ コール・ポリテクニークに変えた.ナポレオンがこの新し い学校の教授の幾人かに「熱気球でどれだけの重量のもの を浮揚できるか? 熱気球で大砲を運搬できるか?」と質 問したとしても,自然なことだったろう.

当時モンゴルフィエ兄弟によって新しく開発された熱気 球は、人を乗せて浮揚し、戦場の偵察をするために使われ ていた.もし熱気球で大砲を浮揚させることができ、高速 で移動できれば、フランス軍に対して、計りしれない利点 があったと考えられる.ナポレオンが本当にそのような質 間をしたかどうかは定かでないし、もししていたとしても 内容は秘密("secret d'Etat")として扱われたかもしれな い.しかし真実はどうであれ、エコール・ポリテクニーク の教授や学生達の研究によって、高温の気体の科学は、フ ランスで急速に発展した. 熱力学は、あらゆる物質に対して当てはまる熱エネル ギーの一般的な物理学である.式(1)に示す気体の法則、 状態方程式は、空気の特性を記述する.ジョセフ・ゲイ・ リュサックによりはじめて式(1)が発表され、ついでラ ザール・カルノーと、ニコラ・レオナール・サディ・カル ノーの親子によって熱力学という学問が発展した.これら 3人はエコール・ポリテクニークの教授や学生であった.

(1)式によれば、空気の密度は $N/V = p/k_{\rm B}T$ のように温度に反比例する.熱気球の中の空気は外界に対して開放されているから、内部の圧力は大気圧とほぼ等しい.しかし、内部の気体の温度が高ければその密度は小さくなり、周囲の気体より軽くなるので気球は浮揚することができる[1].熱気球の大きさには限界があり、中の気体の温度にも実用的な限界がある.いずれにしても、ナポレオンの質問に答えるためには、高温の空気の状態方程式の情報が必要であった.

2.1.2 高温の蒸気

蒸気タービンは大型の機械で,発電用に用いられてい る.蒸気タービンを設計する技術者は,式(1)のそれとは 大きく異なっている,水と蒸気の状態方程式を知っている 必要がある.冷媒蒸気表(steam table)と呼ばれて出版さ れている表があり,その中には,液体から蒸気へ相転移す る状況も含め,1600Kまでの温度範囲において,実測され た水の状態方程式のデータが記載されている[2].

大型の蒸気タービンでは,再生 (regenerative),再熱 (reheating) と呼ばれる方式が用いられている.再生とは, タービンを駆動し,膨張,冷却された蒸気のエネルギーを, 水の加熱,蒸発に使うエネルギーの一部として使う方式を 指し,再熱とは蒸気を再加熱することで,タービン翼がで きるだけ乾燥した状態を保ちながら,蒸気から効率的にエ ネルギーを取り出す方法を指す.その技術が重要な理由

Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley CA94720-8201, USA

は、水滴がタービン翼に付着すると損傷を引き起こすから である.発電のコストにおいては、1%の向上でも大きな 経済的な効果があるから、これらの技術は検討するに値 し、蒸気の状態方程式を知って活用することは重要である.

2.2 レーザーで加熱された物質に対する現代の 状態方程式

現代の科学技術においても物質の状態方程式の情報は必要である。例えば、レーザーによる切断、穴あけ加工において、2つのレーザーパルスで短い時間間隔をおいて照射すると最もよい結果が得られることが知られている(図1)[3].例えば加工する物質を、鋼からタングステンへと変えたような場合に、最もよい結果を得るためには、レーザーのパルスエネルギーと時間間隔を変える必要があるだろう。切断、穴あけの品質と速度を向上させるために、実験的には、試行錯誤が行われるが、高温の金属および金属蒸気の状態方程式があれば、コンピュータシミュレーションによる最適化もできるようになる。試行錯誤的な実験を主とする研究開発でも、コンピュータシミュレーションは、実験結果の正しさを確認したり、どのようなレーザーを購入するかを決めるために役立てられている。

日本原子力研究開発機構では,主に鋼を対象として, レーザー光の吸収,溶融,蒸発過程を考慮して,レーザー 切断,溶接の数値モデリングを行っている.このようなシ ミュレーションの結果は,原子炉容器や冷却管などに用い られる材料の高温での熱物性値(状態方程式,熱伝導率, 表面張力,溶融の潜熱)の値に依存する[4-7].

また,次世代の半導体リソグラフィ技術の開発のために 行われた,レーザー生成プラズマを用いた極端紫外 (EUV)光源の研究開発[8]の中で,パンチアウトターゲッ トという,プリパルスレーザー照射に伴って発生する衝撃 波でSnの薄膜を破砕して発生した蒸気,あるいは微粒子を メインパルスレーザーで加熱する方法が見出された(図2) [9].Snの状態方程式は,蒸気の温度,密度をコンピュータ シミュレーションで評価するためにも重要である.

2009年から2012年にかけて、米国ローレンスリバモア研 究所で行われた、核融合点火実証キャンペーン (National



図1 レーザーによる穴あけ加工によるダブルパルス照射の利 点.厚さが 0.1 cm のステンレス鋼の板に、直径約 40 µm の穴あけを行なった例を示す.左図は、800個のナノ秒パル ス照射による結果、右図は200個のダブルパルス照射によ る結果を示す. Ignition Campaign) では、NIF レーザーを用いた慣性核融 合の実験において、いまだに期待された点火が実現されて いない.この原因はまだ明らかではないが、核融合ター ゲット物質中の状態方程式の不確定性もその理由の一つで はないかといわれている[10].もし実験条件の設計におい て用いられた状態方程式が十分正確でなければ、レーザー 爆縮されたプラズマが、DT 燃料の点火に必要な温度、密 度に至らない可能性がある.

その他の状態方程式データが重要な役割を果たす応用分 野として,実験室における衝撃波実験,燃焼実験,磁場閉 じ込め核融合におけるペレット入射[11,12],X線レー ザー等が挙げられる.図3は,核融合科学研究所の大型へ リカル装置(LHD)の実験において撮影された,燃料ペ レット入射の瞬間を捉えたスナップショットである.入射 後時間が経過してプラズマが膨張する過程は,装置の中の 磁場強度分布によって決まるが,初期のペレットのアブ レーションの過程は,高密度の固体物質が蒸発する過程で



図2 レーザー光を照射し、Sn薄膜をパンチアウトして生じたプ ラズマの雲の挙動.レーザー光は下から照射され、プラズ マ雲が上向きに伝播する.第2パルスレーザーで加熱する 際のプラズマを示す.プラズマのダイナミクス(速度、大 きさ、密度)は、レーザーパルスの条件とSnの状態方程式 から決まる.



図3 核融合科学研究所の大型ヘリカル装置(LHD)に高速で入 射されるペレットの様子.ペレットには燃料(H₂)や、ト レーサー用の不純物が含まれる.入射初期のペレットの挙 動は、高温プラズマ環境における、ペレット物質の状態方 程式に敏感である.背後の曲線状に発光している部分は LHDの内壁である. あり,明らかに状態方程式に敏感である.すでに,アブ レーションの過程の詳細な計測が行われている.

これとは別に,パルスパワー放電を用いて,キャピラリー や水中に閉じ込められた高温,高密度プラズマを生成する 実験が行われている.これらの実験のモデリングは,状態 方程式と放電媒質の電気伝導度のモデルとを組み合わせて 行われている[13,14].現在実験の解析は,既存の状態方程 式データを用いて行われているが,実験の結果はデータの 精度,信頼性の向上に役立つとも考えられる.

恒星や惑星の内部構造を理解するために,これらの星の 内部に存在する物質,H,H⁻,Heの混合物や,Fe,Fe₂O₃ などの状態方程式が必要である.このため,レーザープラ ズマを使った状態方程式の実験は,Takabeらが実験室天 文学と呼ぶ新しい研究分野の基本的な部分になっている[15].

2.3 レーザープラズマ相互作用実験における状 態方程式の役割

2.3.1 物質がどれだけ高温になるかを知る

典型的なレーザープラズマ相互作用実験で、初期にレー ザーのエネルギーはターゲット表面の表皮厚さ (10^{-6} cm) 程度の領域に吸収される.このエネルギー、すなわち、 $E_{dep} = レーザーのエネルギー/加熱される物質の質量、に$ よってターゲットの温度が上昇する.その大きさは比熱により、

$$kT \sim E_{\rm dep}/C_{\rm v},\tag{2}$$

と表される. 定積比熱 C_v は, 状態方程式の重要な要素であ るが, 与えられたレーザーエネルギーで到達しうる最高の 温度を決定する. 高温プラズマは, 温度に応じて光, 紫外 線, 時には X線さえも放射して, 自身で膨張, 冷却する. こ れらのことから, 比熱の値は, 短パルスレーザー励起によ る X 線源や EUV 光源などの応用のために重要である.

2.3.2 物質がどれだけ高速で運動するかを知る

レーザーで加熱された媒質は高い圧力を発生するので, すみやかに膨張する.プラズマの膨張速度は,媒質の種類 で決まる音速の数倍程度である.音速は,物質の状態方程 式より,

 $C_{\rm s}^2 = (\,\mathrm{d}p/\mathrm{d}\rho\,)_{\rm S},\tag{3}$

と表される.この式で,音速は,その二乗が,エントロピー Sを一定とした場合の圧力の密度に対する微分で表されている.

2.3.3 物質がどれだけの温度,密度状態になりうるかを 知る

現在のレーザープラズマ相互作用実験では、様々な照射 配置を用いることで予め設定した流体運動を実現できるよ うになっている.慣性核融合を実現する目的では、水素燃 料を高密度に爆縮する実験が行われている.衝撃波実験で は、衝撃波の速度を測定することによって、比較的容易に 物性の詳細な情報が得られる.他のガスパフやプラズマプ ルームにおいて、密度が既知のプラズマを作る実験が行わ れている.これらのプラズマは光源としても用いられる. ガスパフから生成するプラズマの密度,温度は照射レー ザーのエネルギーやパルス幅によって決まるが,詳細な条 件は高温物質の状態方程式に強く依存する.

2.4 高温物質の状態方程式

化学燃焼の火炎の温度は最高で 2000-3000 K であるの に対して、レーザー照射プラズマはより高い温度に加熱さ れ得る.このような高い温度を測る時は、電子ボルト (1 eV=11605 K)の単位を用いるのが便利である.

1 eV 以上の温度では、いかなる物質も溶融するため、物 質の強度や結晶構造は意味をもたないし、ほぼすべての物 質は蒸発するので、表面張力も働かないと考えられる. ほ とんどの分子は解離する.

もっとも重要な効果は電離であり、自由電子と正電荷か らなる高密度プラズマが生成する.プラズマが加熱される と電子温度が上がるが、電離度も高くなる.ある電子温度 $k_{\rm B}T$ において、プラズマの電離を一価進めるためには、通 常 $k_{\rm B}T$ よりも十分大きいエネルギーが必要であり、電離状 態は自ずと決まる値となる.

一般に,電子温度が5Z²eV以上になるとプラズマは完全 電離状態(*Z** = *Z*)になる.

電離状態の評価のための近似式

温度*T* では、原子は、軌道電子が次々とはぎ取られて、価数*Z**のイオンのイオン化ポテンシャル $I(Z, Z^*)$ が $k_{\rm B}T$ の数倍であるような状態まで電離する.

$$I(Z, Z^*) \cong 13.6Z^{*2}/n^2 \,\mathrm{eV},$$
 (4)

$$p \simeq (Z^* + 1) kT / V_a$$
,

 $E/atom \approx 1.5(Z^*+1)kT + E_i(Z^*).$ (5)

式中で, Z^* は原子1個あたりの自由電子の数, あるい は電離度を, Z は原子番号, n は最外殻電子の主量子 数を示す. 圧力, エネルギーの式中で, Z^* に比例する 項は自由電子の運動の寄与を, +1の項はイオンの運 動の寄与を示す. $E_i(Z^*)$ は, 原子を Z^* 価まで電離す るために必要なエネルギーであり, エネルギーの中で 最も大きく寄与する. イオン化ポテンシャルは,

 $I(Z,Z^*) = \Delta E_I / \Delta Z^*$

のように表され、(4)式は近似式である.

2.4.1 より正確な電離状態の評価

QMD (Quantum Molecular Dynamics:量子分子動力学 法)は、高密度プラズマ中での原子構造と状態方程式を計 算するために非常に役立つ現代的な手法である[16]. QMD は粒子シミュレーションのひとつで、シミュレー ションボックスの中に多数の原子を有し、原子に対して現 実的な境界条件で計算を行うが、非常に長い計算時間を必 要とする.高速の計算機を持つ専門の研究者が使用する と、固体物理および衝撃波の実験データにより検証されているように、高温プラズマの状態方程式その他の特性を高 精度で求めることができる.

1949年に, Feynman, Metropolis, Teller[17]らは, 次の ようにトーマスフェルミ電子ガス理論を, 高温プラズマ中 での原子の電離の記述に適用する方法を考案した. 原子は 密度で決まる半径の球状のセルに閉じ込められていると し, 静電エネルギーは自己無撞着場の方法で決まるとし た. この方法は単純だが,より正確な方法で求めた値と誤 差が10-15%以下で一致するため,現在も有用と考えられ ている.しかし,現在の研究者はより正確な方法について 検討している.

さらに新しい量子セル法では、球状セルに入っている一 つの原子を考える(Liberman[18,19], Faussurier および Blancard[20,21], Blenski[22]らを参照). セルの大きさ は、この方法でも原子の密度から決定される.電子状態は 自己無撞着ポテンシャル下での、シュレディンガー方程式 またはディラック方程式を解いて求める.ポテンシャル は、有限温度フェルミ統計を使って求めた電子状態への分 布より、電子の電荷密度を求めて計算する.この理論の原 子に関する部分は相対論的量子力学を用いているが、球状 セルの境界条件の決め方に不確定性があって現在も研究が 続けられており、その問題点がChihara[23,24], More [25], Blenski[22]らによって議論されている.このセル モデルは、基本的に1電子の量子力学であるため、エネル ギー準位の微細構造は考慮されない.

これらとは別の方法に、もともと宇宙物理で用いられた サハ方程式を用いる方法がある.この方程式では、実測さ れた原子の各電離状態(例えば Sn⁰, Sn¹⁺, Sn²⁺など)の 原子データに基づき、例えば、

 $Ion(Z, Z^*) \leftrightarrow Ion(Z, Z^{*+1}) + e^{-},$ Sn³⁺ \leftrightarrow Sn⁴⁺ + e,

のように、電離過程を化学反応のように考える.サハ方程 式を用いると、原理的には、正確な原子データによって電 離度が正確に評価できると考えられるが、励起状態につい ては十分な情報が得られないのが普通であり、特に複雑な 多電子原子についてはその傾向が強い.また、近傍に存在 する原子との相互作用は、密度効果と呼ばれるが、一般に 近似的に取り扱われる.

2.4.2 密度効果(強結合、フェルミ・ディラック統計、圧 力電離)

プラズマ中の局所的なイオンの配置を考えた密度効果に ついての研究は, Brush-Sahlin-Tellerによって始めら れ, Hansen[26], Dewitt, Ichimaru[27,28]らによって1 成分プラズマ(OCP)の理論にまとめられている.この理 論は,上述の球状セルモデルが正当であることを示すとと もに,モデルをより現実的なものとするための試みに対し て重要な役割を果たしている.

自由電子のフェルミ統計は,固体物理ではよく知られて いる[29].フェルミ統計は,通常の固体密度では,温度が 10 eV 程度のフェルミエネルギーまでの状態方程式等の金 属の物性に,大きな影響を与える.

圧力電離は、固体においてよく知られている現象である

[29,30]. 孤立原子は,低密度,低温では,通常中性である が,固体中では,外殻電子を伝導帯に放出し,正イオンに なり得る. 共通の伝導体へ励起される電子は,通常フェル ミ統計に従う.通常の固体密度よりもずっと密度が高くな ると,より多くの電子が伝導体に励起されて,実効的なイ オンの価数も大きくなる.

2.5 固体の温度1eV への加熱

温度が1000 K までの固体の熱的な特性は,前世紀の初頭 に既に調べられており,興味ある5つの近似的な法則が求 められていた.

その第1は、融点が音速の二乗に比例する法則,

$$T_{\rm m} \sim A M_{\rm p} C_{\rm s}^2, \tag{6}$$

である. ここで AM_p は原子量, C_s は音速である. このよう な関係が生じる理由は,分子の化学結合が強く,物質が硬 ければ,そのような固体中では音速が速く,同時に溶融も 起こりにくいことにある. (図 4 a) に示す,いろいろな物 質における音速と融点の関係からわかるように,式(6)は 近似的な関係である. 図では,融点の温度は,原子一個あ たりの erg (=10⁻⁷ J) で表したエネルギーを,gram で表 した原子質量で割ったものになっている. 音速は縦波と横 波で異なり,また結晶の方向によっても異なるので,式 (6)は非常に正確ではないが,それでもなお凝縮系におけ る機械的特性と熱的特性の一般的な関係を記述している.

第2の法則は沸点の温度は融点の温度の通常1.7倍ということである.この関係の精度の限界も(図4b)に示されている.

第3の法則は,溶融における一原子あたり eV で表した 潜熱は, eV で表した融点の温度に等しく,沸騰の潜熱は沸 点の温度の10倍ということである.この比率はすべての物 質でほぼ同じである.その理由は,溶融や沸騰の際のエン トロピーの変化は,固相あるいは液相における典型的な原 子の配置の変化によっているからである.この点では,固 体の結晶構造の違いや,液体の構造の違いはあまり大きな 違いを生じない.

第4の法則は,温度を eV で表し,一原子あたり(eV/ atom)の単位で表した時の,固体の定積比熱は,ほとんど の物質でおよそ3ということである(図4d).この法則 は,デュロン・プティの法則として知られ,3という値は, 固体を構成する原子が平衡位置からずれて小さく振動した 時の,運動エネルギーとポテンシャルエネルギーの寄与が ほぼ等しいことによる.この法則は温度が室温程度 (0.025 eV)において成り立つ.より低温では,Einstein とDebyeによって最初に示されたように,量子効果によっ て比熱は減少する.原子番号の小さい物質では,室温でも 量子効果が現れる(図4d).このことは,原子一個あたり の比熱が,

 $\delta E_{\text{thermal}} \sim 3k_{\text{B}}T/\text{atom},\tag{7}$

であることを意味する.この値は式(1b)に表した理想気体における値の2倍であり、その違いは液体や固体中の原

子は,振動に伴うポテンシャルエネルギーと運動エネル ギーの両方をもつことによる.

最後の第5の法則は、高温の固体の圧力に対するもの、

$$p(\rho, T) = p_0(\rho) + \gamma \rho \delta E_{\text{thermal}}, \qquad (8)$$

でグリュナイゼンの法則と呼ばれる. γ はグリュナイゼン 定数と呼ばれ((図4e)を参照),その値は1~3である. 式(8)において,第1項, $p_0(\rho)$ は冷たい圧縮圧力で,固 体の中の原子の間に働く反発力に起因し,固体の圧縮率か ら決まる.第2項は高温固体に起こる追加の圧力で,高温 の物質中の音波に伴う気体の圧力と考えることができる.

これらの法則が成り立つことは、およそ1000 K までの温 度の領域では、実験によって確認されている[29,30].これ 以上の圧力では、実験データは完全とはいえず、更なる研 究が必要である。そして、実際に応用に用いる状態方程式 データは、これらの知られている法則と整合性をもつこと が必要である。

現代の実験的な研究は、2つの方向で行われている. そ の一つはダイヤモンドアンビルセルでの圧縮とレーザーで の加熱を組み合わせた,固体-固体相転移の研究であり,も う一つは衝撃波実験で,圧縮・加熱された媒質中の,衝撃



 図4a 固体の音速 c_s [cm/s]と融点の関係. 図横軸で融点を (kTm/AMp)^{1/2}の形で示す. ただし Tm は融点, AMp は原 子量である. 図は, 力学的な量である音速 c_sと熱的な特性 の関係を示す. 多くの場合, 音速は結晶構造に依存し, 伝 播方向によって異なるので, 関係は近似的なものである.



図4b 融点と沸点の比例関係.

波の伝播速度や物質のエネルギー密度を測定する研究である[31].ただし、この短い講座の中ではこれらの広い実験 研究を紹介することはできない.



図4c 潜熱と転移温度の関係の原子番号に対する依存性. 一原 子あたりの溶融の潜熱は、融点の温度とほぼ等しく、蒸発 の潜熱は沸点の温度のおよそ10倍であることを示す.



図4d 原子の比熱が一原子あたりおよそ3eVとするデュロン・ プティの法則に従うことを示す結果.この傾向は、Debye 温度以上、室温程度では多くの物質に当てはまる.高温で は、イオン化が起こると比熱は顕著に大きくなる一方、完 全電離した低原子番号原子では小さくなる傾向を示す.



図4e 高温固体のグリュナイゼン γ 定数(式8).

2.6 溶融,蒸発および臨界点

状態方程式は1000 Kから10 eV, すなわち100,000 Kまで の温度範囲で用いられるので,溶融や液体-気体相転移を 取り入れることは重要である.もしこの温度領域での物性 定数が正確に知られていない場合は,状態方程式は理論的 に求めるか,よりよく理解されていると考えられている物 質のデータからのスケーリングで求めなければならない.

これらの領域では、いかなる方法を用いて状態方程式を 求めたとしても、気相と液相が同時に共存するような、二 相状態が存在することを考慮しなければならない。内部エ ネルギー E,エントロピーS に対して、ヘルムホルツの自 由エネルギー F = E - TS を基にする現代の状態方程式 では、二相領域の境界は、マクスウェルの規則に従い、液 相と気相の密度から計算することができる。液相の密度 ρ_L と気相の密度 ρ_V は、次の連立方程式を満たす。

 $p(\rho_{\mathrm{L}}, T) = p(\rho_{\mathrm{V}}, T)$ かつ $g(\rho_{\mathrm{L}}, T) = g(\rho_{\mathrm{V}}, T)$,

ここで、 $g = F + p/\rho$ はギブスの自由エネルギーである.こ の非線形連立方程式は特別な方法によって解かれる.実際 には、二相領域において物質は例えば気体と小さな液滴か らなり、物質の特性は低密度の境界における気体の密度 ρ_V と、高密度の境界における液体の密度 ρ_L における値の 線形結合で表される.この時表面張力は、液体を球形の液 滴の形を保つように働き、それゆえ液相部分の圧力は気相 領域の圧力よりも高く、密度も $\rho_V < \rho < \rho_L$ となる.

流体力学においては、物質は局所熱平衡であることを仮 定し、密度と圧力は各場所で決まった値をもつと考える. 高密度、高温の媒質は、通常流体の応答時間よりも早く熱 平衡状態になるので、この仮定は多くの場合適当である. しかしながら、蒸発や凝縮の速度は遅く、蒸発の平衡状態 を仮定することは正しくない可能性がある.したがって将 来の流体シミュレーションでは、非平衡の蒸発の動力学と 流体力学を組み合わせることが課題になると考えられる. また、参考文献[4-7]の中の議論にあるように、流体運動に 対する表面張力の効果も重要である.これらの特性は室温 程度の温度領域で液体になる物質ではよく理解されている が、1000 K 以上の高温における、Sn、Al、Au などの金属 の分子、負イオンなどの特別な状態の生成を伴う液体-気 体相転移は、興味のある研究課題である.

2.7 液体-液体相転移

高圧のリンにおいて実験的に観測されている顕著な液体 - 液体相転移は,局所的な原子の秩序の急激な変化によっ て起こるとされ,今後の研究の可能性について示唆を与え る重要な例である[32,33].X線回折測定によれば,液体中 の近傍分子の配置の急激な変化が観測され,二つの区別さ れる液相の間の転移が存在することはほぼ間違いないとさ れている.いくつかの分子媒質において,同様の液体-液体 相転移がはっきりと存在する.最近の文献ではセリウム [34]やシリコン[35]等で,液体-液体相転移の存在が捉え られている.レーザープラズマの立場では,より高温の金 属中で類似の転移が存在するかが問題と考えられる.

2.8 状態方程式データの取り扱い方法

状態方程式データの数表は、たくさんの数値が並んだ テーブルである.典型的なテーブルは密度について60-100 点,温度について50点程度のデータをもっているが、計算 機の進歩により、特に二相領域付近での分解能を高めた、 より大規模なテーブルが作られるようになっている.

状態方程式データの表を作成する際には,異なる温度, 密度領域での複数の種類のデータ、高温での電離と、低温 での固体における諸関係とを整合性を持って繋ぎ合わせる ことが実際上の課題になっている.少なくとも,圧力と エネルギーの2変数は、温度、密度平面内における、固 体 - 液体の溶融の境界に対応する曲線上で連続である必要 がある.熱力学的な整合性は直ちに検証することができ る. 文献[36]に示すように、QEOS (Quotidian Equation of State:常用状態方程式) では,異なるモデルの間の接続 のために, 融点 $T_{M}(\rho)$ のような与えられた境界において, 値が正確に一致するような関数形を用いるようにしてい る. すなわち QEOS では, 高温固体の 5 つの法則と, イオ ン化について Thomas-Fermi 理論を用い, 固体, 液体, 気 体からプラズマにつじつまの合う記述を用い、相境界で諸 量が自動的に一致するようにしている. 最近の QEOS の応 用では、より多くのパラメータの調整によって、実験との 一致が改善している.

また,状態方程式を実際にプラズマ流体シミュレーショ ンで用いる場合には,テーブルのデータを内挿で求める場 合の誤差もしばしば問題になる.

2.9 例

この章の結論として、図5に、Alの状態方程式を示 す.図ではgramで表した単位質量あたりの内部エネル ギー $E(\rho, T)$ を、固体密度付近で、温度、密度の関数として 示す.液相、気相の二相領域は、相境界をマクスウェルの 規則に従って求めることによって、はっきりと示されてい る.結果を詳しく調べると、驚くべきことに、このような 単純な金属においても、液体 - 液体相転移が存在すること がわかる.

この液体-液体相転移は, Al₂分子の圧力による解離に起 因する.分子とその解離は, 従来の Al の状態方程式のモデ ルには含まれていない.図5に示した状態方程式は拡張し た QEOS [36]によって求められたものであるが,本手法の もつ柔軟性によって, Desjarlaisらによる QMD 計算[16]の 結果に可能な限り近い結果を得ることができている.

図5の状態方程式は、温度0.6 eV において臨界点を持つ. この値は元のQEOS モデルによる値、1.2 eV[36]より もかなり低い.QMD計算の結果は、低い方の値を示すが、 実験的に検証することが必要である.このことは、温度 0.5~5 eV の Warm Dense Matter 領域では、基本的な熱物 性値もまだ完全も確立されていないといわざるを得ないこ とを示している.

2.10 将来の状態方程式の研究

最後に,将来の状態方程式の研究,その計算のためのモ



図5 新たに計算されたアルミニウムのEOSにおける内部エネル ギーE(ρ,T).液体-気体の二相状態に注目して示す.相境 界には、分子の解離に起因する、小さな構造が見られる. これは理論的に予測されているが、実験的には確認されて いない、液体-液体相転移に対応する.

デルや手法について述べておきたい.最も重要な課題は, 非平衡の効果を状態方程式に取り入れることであろう.高 温では,輻射との結合により,電子状態,電離状態は非平 衡になると考えられる.また低温(<10 eV)でも,液体 -気体相転移の時間は,流体運動の時間スケールよりも長 く,非平衡状態になると考えられる.これらの効果を研究 するためには,原子の衝突輻射モデルや分子動力学シミュ レーションが用いられる.

実験研究でも、短パルスレーザーを用いたポンププロー ブ実験で、短パルスレーザーで加熱されたターゲットの流 体運動の初期過程を観測するなどの新しい手法が試みられ ている.Yonedaらによって、表面で反射されたプローブ光 の偏光は、わずかな表面の動きにも敏感なことが確かめら れ、既知のレーザーの吸収エネルギーに対するプラズマの 膨張速度に関する情報が得られている[37].このように、 実験研究に対しては、いつでも、従来の実験技術で得られ る範囲外の条件における物性値を収集し、評価することが 求められている.

謝 辞

本章を執筆するにあたり, G. Faussurier, S. Libby, M. Desjarlais, H. Kitamura 他多くの研究者からの示唆に感 謝する. 日本語への翻訳は主に A. Sasaki によって行われ た.

〔翻訳:佐々木 明〕

参 考 文 献

- [1] 竹内 淳: 高校数学でわかるボルツマンの原理 (講談 社, 2008).
- [2] J. Keenan et al., Steam Tables (John Wiley & Sons, NewYork, 1969). (冷媒蒸気表は, Handbook of Chemistry & Physics m にも記述されているが,単位はBTU (British Thermal Units) で,温度を華氏,圧力を1平方インチ 当たりポンドで表している).

- [3] A. Forsman et al., J. Appl. Phys. 98, 033302 (2005).
- [4] T. Yamada et al., Proc. 19th International Conference on Nuclear Engineering, ICONE-19-44128 (2011).
- [5] S. Yamashita et al., Proc.19th International Conference on Nuclear Engineering, ICONE-19-43939 (2011).
- [6] K. Sugihara et al., Proc. 20th International Conference on Nuclear Engineering, ICONE-20-54185 (2012).
- [7] T. Yamada *et al.*, J. Laser Micro/Nanoengineering 7, 244 (2012).
- [8] K. Nishihara et al., Phys. Plasmas 15, 056708 (2008).
- [9] T. Ando et al., Jpn. J. Appl. Phys. 47, 293 (2008).
- [10] "Science of Fusion Ignition on NIF", DOE report LLNL-TR-570412, May 22, 2012.
- [11] R. Sakamoto et al., Nucl. Fusion 44, 624 (2004).
- [12] M. Goto et al., Plasma Phys. Control. Fusion 49, 1163 (2007).
- [13] T. Sasaki *et al.*, J. Phys. Conference Series **112**, 042026 (2008).
- [14] T. Sasaki et al., Laser Part.Beams 24, 371 (2006).
- [15] H. Takabe, Progr. Theor. Phys. Supplement 143, 202 (2001).
- [16] A. Mattson *et al.*, Modeling Simul. Mater. Sci. Eng. 13, R 1 (2005).
- [17] R. Feynman et al., Phys. Rev. 75, 1561 (1949).
- [18] D. Liberman, Phys. Rev. B20, 4981 (1979).
- [19] D. Liberman, JQSRT 27, 335 (1982).
- [20] C. Blancard and G. Faussurier, Phys. Rev. E 69, 016409 (2004).
- [21] S. Kiyokawa, J. Phys. Soc. Japan 24, 4708 (1995).
- [22] J.-C. Pain *et al.*, "Equation of State of Dense Plasma Mixtures", *to be published*.
- [23] J. Chihara, J. Phys. Condensed Matter 12, 231 (2000).
- [24] J. Chihara, Prog. Theoret. Phys. 111, 339 (2004).
- [25] R. More, Advances in Atomic and Molecular Physics 21, 305 (1985).
- [26] J.-P. Hansen and I. McDonald, *Theory of Simple Liquids* (Academic Press, London, 1976).
- [27] H. Kitamura and S. Ichimaru, J. Phys. Soc. Japan 67, 950 (1998).
- [28] S. Ichimaru and S. Ogata, *Elementary Processes in Dense Plasmas*, (Addison-Wesley, Reading Mass., 1995).
- [29] N. Mott and W. Jones, *Theory of the Properties of Metals and Alloys* (Dover Publications, New York (1958).
- [30] N. Ashcroft and N. Mermin, *Solid State Physics* (Holt, Rinehart and Wilson, New York, 1976).
- [31] V. Fortov, "Extreme States of Matter", Springer-Verlag, Berlin (2011) 加えて Mozhnie udarnie volni i eksperimal'nie sosshoyaniya beshchestba, Nauchnaya lektsiya pri vruchenii, bol'shoi mezdunarodnoi zolotoi medali im. A. Einsteina po fizike, Izdatel'stvo "Bukos", Moskva, Kosmodamianskaya nab. も参照.
- [32] Y. Katayama et al., Nature 403, 170 (2000).
- [33] H. Tanaka, Phys. Rev. E62, 6968 (2000).
- [34] A. Cadien et al., Phys. Rev. Lett. 110, 125503 (2013).
- [35] M. Beye *et al.*, Proc. National Academy of Sciences 107, 16772 (2010).
- [36] R. More *et al.*, Phys. Fluids **31**, 3059 (1988).
- [37] H. Morikami et al., Phys. Rev. E70, 035401 (2004).



MORE Richard

米国ウィスコンシン州生まれ. 経歴:1968 年, Ph.Dカリフォルニア大学ラ・ホヤ 校,1968-76年ピッツバーグ大学助教授,准 教授,1977-99年 米国国立リバモア研究

所(サイエンティスト,グループ長,ディビジョン長),1999-2005年総合研究大学院大学・核融合科学研究所教授,それ以 降,米国国立ローレンス・バークレイ研究所,リバモア研究 所,サンディア研究所コンサルタント.専門分野:レーザー プラズマ,原子物理,核融合.趣味:コンピュータと,中国 の算盤や,日本の亀嵩算盤を使った,数論.

講座 レーザー生成プラズマの新しい温度,密度領域における物性とシミュレーション 3. EUV 光源や ICF におけるレーザープラズマ相互作用の初期過程 ーレーザーアブレーションー

3. Initial Process of Laser-Plasma Interaction in the Extreme Ultra-Violet Light Source and the Inertial Confinement Fusion Plasmas — Laser Ablation —

砂原 淳

SUNAHARA Atsushi 公益財団法人レーザー技術総合研究所 (原稿受付:2013年4月26日)

物質にレーザーを照射すると,照射された物質表面は気体やプラズマとなって噴出する.この"レーザーア ブレーション"の時間発展を記述する計算機シミュレーションのモデルについて考える.レーザーアブレーショ ンにおいてターゲットとなる物質はレーザー照射開始時に固体や液体であることが多く,レーザー照射により気 体やプラズマへと状態が変化する.そのため、レーザー照射初期の固体状態からプラズマ状態に至るまでの幅広 い密度・温度領域カバーするモデルが必要になる.本章ではレーザーアブレーションの計算機シミュレーション で広く用いられている輻射流体力学モデルをベースに,物質の状態方程式や電子の輸送,電子とイオンまたは格 子振動とのエネルギー緩和,レーザーの伝播,吸収,輻射輸送など,重要な物理過程の扱い方について説明する. さらに,固体状態からプラズマ状態までの幅広い密度・温度領域をどのように記述するかについて述べる.また, レーザー照射された物質がレーザーパルス初期にどのように電離してプラズマ状態に至るのかを自由電子の発生 を中心に簡潔に述べる.

Keywords:

nano-second laser ablation, radiation hydrodynamic simulation, two-temperature model, thermal conduction, radiation transfer

3.1 はじめに

極端紫外(Extreme Ultra-Vioket:EUV)光源やレーザー 核融合プラズマにおけるレーザープラズマ相互作用の初期 素過程のモデリングの現状と課題を示すのが本章の目的で ある.EUV光源であれば金属であるスズのドロップレット (液体または固体),レーザー核融合であれば内側のDT の核融合燃料層と外側のプラスチック(CH)アブレーター からなる燃料ペレットにレーザーを照射する.いずれも初 期にはプラズマでない状態からプラズマへと時間発展す る.このレーザー照射初期のプラズマ生成やその後の時間 発展はどのように扱うべきだろうか.

本章ではまず、どのようにプラズマが生成されるのか? という問題について、自由電子の生成を中心に記述する. ここでは多光子吸収やトンネル電離、逆制動放射が重要に なる.続いて、プラズマの時間発展をどのように計算する かについて、現状のモデルを説明する.ここではターゲッ トにレーザーが照射され、吸収されたレーザーエネルギー がどのように物質中に広がり、物質の密度や温度の変化に 結びつくのかを輻射流体力学モデルをベースに考える.そ して初期にはプラズマではない状態からプラズマ状態まで の幅広い領域の物性をどのように統一的に記述するかについて考える.

3.2 自由電子の生成

プラズマ状態を固体,液体,気体に次ぐ第4の物質の状 態として例える際, 我々はプラズマを"電離している状態" として他の3つの状態と区別している[1]. レーザー生成 プラズマという場合,レーザーをターゲット物質に照射 し、電離度が低い物質状態から高い状態へと遷移させるこ とこそがレーザーによるプラズマ生成過程といえる. 金属 のように金属内の原子間を比較的自由に動くことができる 電子(これを伝導帯電子、または完全にポテンシャルフ リーではないが、原子間を自由に動けるという意味で自由 電子と呼ぶことにする)が存在する場合はレーザーを照射 する以前から、ターゲット物質にはある程度の電離度があ り、物質内に自由電子が既に存在するものとして以後の レーザー吸収の素過程を考えればよい.しかし、伝導帯に 電子が存在せず、禁制帯にのみ存在する誘電体の場合には "最初の1個目の自由電子"がどのようにできるかを考え る必要がある. その場合の電離はレーザー強度にもよる

Theory and Computation team, Institute for Laser Technology, Suita, OSAKA 565-0871, Japan

author's e-mail: suna@ile.osaka-u.ac.jp

Lecture Note

が、多光子吸収 (Multi-photon absorption) によって生じる ことが多い[2]. ε_I をイオン化に必要なエネルギーポテン シャルギャップ、光子のエネルギーを $h\nu$ とすると、 $m > int[\varepsilon_I/h\nu+1]$ の条件を満たす m 個以上の光子が同時 に遷移に寄与することにより、禁制帯から伝導帯への電子 の遷移が生じる. 1 µm の波長の光子はほぼ1 eV のエネル ギーを持つから、物質のエネルギーギャップが 10 eV 程度 であるとすると、10個以上の光子が同時に遷移に寄与する 必要がある. ほとんどの場合で最初の自由電子を生成する 物理過程は多光子吸収である[2]が、現実のターゲット物 質には不純物が含まれていることが多く、もっと小さいエ ネルギーギャップが生じ、1 個の光子でも自由電子を生成 する場合もある.

一方、レーザー強度がさらに高くなり、電子が束縛され ているポテンシャル障壁そのものが電場の影響を受けて歪 むと、ポテンシャル障壁が実効的に低くなる.このとき電 子はトンネル効果により、ポテンシャル障壁の外に出るこ とが可能になる.これをトンネル電離(tunnelionization)ま たは電界電離(field ionization)という.

多光子吸収,トンネル電離のどちらも光電離吸収過程で ある. KeldyshはKeldysh parameter γと呼ばれるフリーパ ラメータを導入して多光子電離とトンネル電離レートを統 一的に扱う式を導いた[3]. Keldysh parameter γ は

$$\gamma = \frac{\omega}{\omega_{\rm t}} = \frac{\omega\sqrt{2m_{\rm e}I}}{e\,\mathcal{E}} = \sqrt{\frac{I}{2U}} = \frac{1}{2K_0F},\tag{1}$$

で与えられ, ω はレーザーの(角) 周波数, ωt は電子がポ テンシャルをトンネルする周波数, E は振動電場の振幅, $K_0 = I/(\hbar\omega)$ はイオン化ポテンシャルIのイオン化に 必要な光子hωの数, FはF= $\mathcal{E}/(\kappa^2 \mathcal{E}_a)$, $\kappa = \sqrt{I/I_{\rm H}}$, $\mathcal{E}_a = m_e^2 e^{5} / \hbar^4 = 5.14 \times 10^9 \, \text{V/cm}, \ I_H = 13.6 \, \text{eV} \ \Columbus \delta[4].$ また, U はポンデラモーティブ ポテンシャル (ponderomotive potential) $(\sigma \mathfrak{s} \mathfrak{h}), U = e^2 \mathcal{E}^2 / (4m_r \omega^2), m_r = m_e/2 \ (\sigma \mathfrak{s} \mathfrak{s})$ る.よって, γ= {(イオン化ポテンシャル) / (ポンデラ モーティブ ポテンシャル) } 1/2 ともいえる. γ ≪1 であるほ ど、トンネルする電子からみると、定常的なレーザーの電 場がかかり、ポテンシャル障壁が下がることによってトン ネル電離が生じやすくなる.反対にγ>1では多光子電離 が生じやすい. また, トンネル電離では最外殻の電子から 電離するが、多光子吸収電離では主量子数npが小さい程断 面積が大きく、内殻からの電離が生じる. プラズマ生成の 際,電離以外の過程を含めた電子の数密度neの時間発展は 次の式で与えられる[5].

$$\frac{\partial n_{\rm e}}{\partial t} = \nu_{\rm i} n_{\rm e} + W_m I^m n - \nu_a n_{\rm e} - \nu_{\rm R} n_{\rm e} + \nabla \left(D \,\nabla n_{\rm e} \right). \tag{2}$$

ここでは多光子吸収を考え,電離 m 個の光子によって $m\hbar\nu > \epsilon_I$ となるから,電離レートは $W_m I^m$ とする. n を中 性粒子またはイオンの数密度, ν_i は衝突電離レート, ν_a は電子付着レート, ν_R は再結合レート,最後は拡散項であ る.多光子吸収またはトンネル電離によりひとたび自由電 子が生成されると,レーザーの電場で振られた自由電子が 中性粒子またはイオン粒子と衝突することにより振動エネ ルギーを熱化してエネルギーを得る.この過程を逆制動放 射(Inverse-bremsstrahlung)という.エネルギーを得た電 子は原子に衝突し,電子衝突電離(electron impact ionization)して,電子数は増加する.そのとき,励起やイオン化 に使われる以上のレーザーエネルギー吸収が生じると,電 子衝突電離が連続的に生じ,雪崩的に電離が進む.これを 電子雪崩(electron avalanche)という.これにより自由電 子数が急速に増加し,初期プラズマが生成される.

3.3 輻射流体力学モデル

レーザーアブレーションを記述する流体近似のモデルと して次に示す一流体二温度の輻射流体力学モデル,または 単に二温度モデル (Two Temperature Model)[6,7]が広く 用いられている.

$$\frac{D\rho}{Dt} = -\rho \,\nabla \cdot \boldsymbol{v} \,, \tag{3}$$

$$\frac{D \mathbf{v}}{Dt} = \nabla \left(p_{\mathrm{i}} + p_{\mathrm{e}} \right), \tag{4}$$

$$\rho c_{\rm vi} \frac{DT_{\rm i}}{Dt} = -p_{\rm thi} \nabla \cdot \boldsymbol{v} - Q_{\rm ei}, \qquad (5)$$

$$\rho c_{\rm ve} \frac{DT_{\rm e}}{Dt} = -p_{\rm the} \nabla \cdot \boldsymbol{v} + Q_{\rm ei} + \nabla \cdot (\kappa_{\rm e} \nabla T_{\rm e}) + S_{\rm e}.$$
(6)

ρは質量密度, vは速度, T_i , T_e はそれぞれ格子 振動(phonon)またはイオン(ion)の温度,電子(electron) の温度である. $p_i = p_i(\rho, T_i)$ は格子振動またはイオ ンの圧力, $p_e = p_e(\rho, T_e)$ は電子圧力であり, $p_{thi} = p_{thi}(\rho, T_i) = T_i \left(\frac{\partial p_i}{\partial T_i}\right)_{\rho}$, $p_{the} = p_{the}(\rho, T_e) = T_e \left(\frac{\partial p_e}{\partial T_e}\right)_{\rho}$ 定義される. これらはそれぞれ密度,温度の関数として, 状態方程式モデルに基づいて与えられる. Q_{ei} は電子と格 子振動またはイオンと電子とのエネルギーの衝突緩和 (relaxation), S_e はレーザー加熱,輻射加熱など,単位体積 あたり単位時間あたりの外部から電子へのエネルギー入力 を表す. κ_e は電子の熱伝導度(thermal conductivity)であ る. $c_{vi} = c_{vi}(\rho, T_i)$, $c_{ve}(\rho, T_e)$ はそれぞれ,イオンと電子の 比熱 (specific heat)である. これも圧力と同じく,密度・ 温度の関数としてモデルで与えられる.

この一流体二温度モデルは、電子とイオンを一体となっ て動く流体とみなし、イオンまたは格子振動と、電子のそ れぞれのエネルギー式を考えるため、電子間、イオン間 (または格子振動間)のエネルギー緩和時間より長い時間 スケールを扱うのに有効である.電子とイオンで電荷分離 が生じるような場合や、フェムト秒レーザー照射時に、電 子がマクスウェル分布になる緩和時間よりもレーザー照射 のパルス幅が短かい場合など、明らかに適用範囲外の問題 を除き、多くの問題に適用されている.しかし現実には、 式の中で使われる圧力や比熱、熱伝導係数やレーザー吸収 率等の物性値が正しく与えられるか?という大きな問題が ある.物性値データが計測され、データベース化されてい ることもあるが、往々にしてデータが限られていたりす る.これらを順に考察する.

3.3.1 状態方程式

レーザーアブレーションのシミュレーションの状態方程 式はQuotidian Equation of State:QEOS[8]が広く使われて いる.また、いくつかの物質についてはLos Alamos研究所 のSESAMEテーブル[9]が利用できる.比熱や熱伝導係数 などの物性値については産業技術総合研究所の分散型デー タベースも利用できる[10].いずれにしても、固体からプ ラズマまでの全てを精度よくカバーする状態方程式のモデ ルは未だ探求されつづけており、詳細は本講座第2章を参 照していただきたい.

3.3.2 電離度

次に電離度について考える. レーザープラズマ中の電離 度は Collisional Radiative Steady State (CRSS) に基づいて 計算されることが多い[11]. これはプラズマ中の衝突過 程,輻射過程を考慮したレート方程式を定常を仮定して解 くもので、高密度極限では局所熱平衡 (Local thermal equilibrium: LTE) になり、低密度極限ではコロナ平衡 (Corona Equilibrium: CE) になる[12].図1にシンプルな CRSS で計算したアルミの電離度を示す. 高密度低温側で はLTEであるが、高温もしくは低密度になると相対的に輻 射過程が衝突過程に比べて無視できなくなり、衝突輻射平 衡 (Collisional Radiative Equilibrium: CRE) になる. さら に低密度になると衝突で励起され、放射脱励起するコロナ 平衡になる. コロナ平衡になると電離度は密度に依存しな くなる. 図から, 密度・温度領域は LTE, CRE, CE の 3 つの領域に分かれることがみて取れる. 固体のターゲット にレーザーを照射すると最初はLTEの状態にあるが,加熱 され, 膨張したプラズマは CRE 領域に向かう. ほとんどの アブレーションでは固体(典型的なイオン密度 10²² cm⁻³) から膨張気体もしくはプラズマ(典型的なイオン密度 10¹⁹ cm⁻³) に一気に膨張するが,温度が低いままであれば LTE ですべてをカバーできる.

LTE であればいくつかの方法で比較的簡単に電離度を 計算できる. 例えば, $T = T_e$ として Saha-Eggert 方程式

$$\frac{n_{\rm e}n_{r+1}}{n_r} = \frac{2U_{r+1}(T)}{U_r(T)} \left(\frac{m_{\rm e}k_{\rm B}T}{2\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{I_{\rm r}-\Delta I_r}{k_{\rm B}T}\right),\tag{7}$$

で与えられる[13]. U_r , U_{r+1} はそれぞれ r 価, r+1 価のイ オンの分配関数 (partition function) である. n_r は r 価に 電離した原子の数密度で, r = 0は中性原子, r = 1は 1 価電 離した原子を意味する. n_e は電子の数密度を表す. I_r は r 価からr+1 価へ電離する際のイオン化エネルギー, ΔI_r はイオン化ポテンシャルの低下 (potential lowering) であ る. hはプランク定数, m_e は電子の質量である. 実際に電 離度を求めるには分配関数 U_r , U_{r+1} が必要である.

また,LTEで固体ターゲット等のような高密度の場合は Thomas-Fermiモデルに基づいた電離度評価も可能であ り,電離度のフィッティング公式等が利用可能である



図1 CRSS による AIの平均電離度〈Z〉の計算例.LTE, CRE, CE に分かれる.破線は領域の区分がわかりやすいように付け たものである.

[11].そこで、現実的なレーザーアブレーションのシミュ レーションでは初期プラズマは Saha-Eggert や Thomas-Fermiモデルで電離度を計算し、低密度、高温部分はCRSS で計算したものに切り替えるということになる。CRSS が 原理的にはすべての密度・温度領域をカバーするはずであ るが、すべての準位間のレート係数を正確に考慮すること は容易でない。

3.3.3 電子の衝突周波数

次に、熱伝導やレーザー吸収など、多くのモデルで登場 する電子の衝突周波数 ν について考えてみる.実際の計算 では電子と相互作用する相手が格子振動なのか、それとも イオンなのかで計算に使用する物性が大きく異なるが、そ れらをつないで、固体からプラズマまでを統一的に扱う.

物質状態が固体であれば電子と格子振動との衝突が生 じ,電子-格子振動の衝突周波数は

$$\nu_{\rm p} = K \frac{e^2}{\hbar v_{\rm F}} \frac{k_{\rm B} T_{\rm i}}{\hbar},\tag{8}$$

となる. $v_{\rm F}$ は縮退した電子気体のフェルミ面における速度 で $v_{\rm F} = (3\pi^2 n_e)^{1/3} \hbar/m_e$ である. n_e は電子の数密度, K は実 験を再現するように調整されるパラメータである. Ramis [14]によればAlでK = 18.8 である. また物質がプラズマで あれば電子とイオンとの衝突が支配的となり,電子とイオ ンの衝突周波数は

$$\nu_{\rm e} = \frac{4\sqrt{2\pi}Zn_{\rm e}e^4\ln\Lambda}{3\sqrt{m_{\rm e}}(k_{\rm B}T_{\rm e})^{3/2}},\tag{9}$$

で与えられる.現実の計算では固体から,固体とプラズマ の中間に位置するいわゆる Warm Dense Matter 領域を経 てプラズマに至るすべてを計算する必要がある場合が多 い.固体からプラズマ領域までをカバーする電子の衝突周 波数 ν を統一的に記述することは容易でなく,現実的な方 法としては, ν_p と ν_e の調和平均を採るというのが一つの方 法である[15].この場合,電子と格子振動との衝突周波数 ν は

$$\nu^{-1} = \nu_{\rm p}^{-1} + \nu_{\rm e}^{-1},\tag{10}$$

とする.また,実際の計算では電子-電子衝突も考慮する 必要がある[16].

3.3.4 電子熱伝導

次に電子熱伝導について考える.熱伝導率 κе は一般に

$$\kappa_{\rm e}(T_{\rm e}) = \frac{1}{3} C_{\rm e}(T_{\rm e}) v(T_{\rm e}) \ell(T_{\rm e}) n_{\rm e}, \qquad (11)$$

で与えられ[17], C_e は単位体積あたりの電子の定積熱容量で $C_e = \rho c_{ve}$ である[17]. ℓ は粒子の平均自由行程 $\ell = v_{th}/\nu_e$ である. v_T は熱速度である. $v = v_T$ として,式 (12)変形すると

$$\kappa_{\rm e}(T_{\rm e}) = \frac{C_{\rm e} v_{\rm T}^2}{3\nu_{\rm e}},\tag{12}$$

となる. 熱速度 $v_{\rm T}^2 = k_{\rm B}T_{\rm e}$ より,電子-イオン衝突周波数が 支配的なプラズマ極限では $\kappa_{\rm e}(T_{\rm e}) \propto T_{\rm e}^{5/2}$ となる. 電荷中 性条件等が考慮されるため,まったく同じ式にはなら ないが, Spitzer の電子熱伝導係数と同じ形, $\kappa_{\rm Spitzer} = \kappa_0 n_e k_{\rm B}^2 T_e / (m_e \nu_{\rm Spitzer})$ になる[15].また,金属の固 体などでは縮退していることを考慮し,電子熱伝導係数は

$$\kappa_{\rm e}(T_{\rm e}, T_{\rm i}) = \frac{C_{\rm e}}{3\nu_{\rm e}} \left(v_{\rm F}^2 + \frac{3k_{\rm B}T_{\rm e}}{m_{\rm e}} \right)$$

$$= \frac{\pi^2 n_{\rm e} k_{\rm B}^2 T_{\rm e}}{6\nu_{\rm e} \varepsilon_{\rm F}} \left(v_{\rm F}^2 + \frac{3k_{\rm B}T_{\rm e}}{m_{\rm e}} \right),$$
(13)

と見積もられる[7].ここで、電子比熱 $C_{\rm e} = (\pi^2/2) n_e k_{\rm B}^2 T_e / \epsilon_{\rm F},$ $\epsilon_{\rm F}$ はフェルミエネルギー、 $\epsilon_{\rm F} = \frac{1}{2} m_e v_{\rm F}^2$ である.

3.3.5 電子とイオンの温度緩和

電子とイオンとの温度緩和は係数 γ を用いて $Q_{ei} = \gamma(T_i - T_e)$ と表される.ここで γ は

$$\gamma = \frac{3m_{\rm e}k_{\rm B}}{m_{\rm i}^2}\nu_{\rm e},\tag{14}$$

で与えられ[15], *m*_i はイオンの質量である. *v*_e に*v*_{Spitzer} を代入すれば、プラズマにおける電子-イオンの緩和係数 になる[18].

3.3.6 輻射輸送

次に輻射輸送について概要を記す.より丁寧な解説は文 献[19]を参照されたい.輻射輸送は一般的には空間3次 元,運動量空間3次元の6次元の位相空間でボルツマン方 程式を解くことになるが,計算負荷が大きすぎて現実的で ない.そのため,何らかの近似を用いて輻射輸送を現実的 な精度で解くという方法が採られる.

輻射輸送の0次と1次のモーメント式は次のように表される.

$$\frac{\partial E_{\nu}}{\partial t} + \nabla \cdot F_{\nu} = 4\pi \eta_{\nu} - c \chi_{\nu} E_{\nu}, \qquad (15)$$

$$\frac{\partial \mathbf{F}_{\nu}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{P}_{\nu} = -c \left(\chi_{\nu} + \sigma_{\rm s} \right) E_{\nu}, \qquad (16)$$

ここで E_{ν} は輻射エネルギー $h\nu$ の輻射エネルギー密度であ り, \mathbf{F}_{ν} は輻射エネルギー流束, \mathbf{P}_{ν} は輻射テンソルである. $4\pi\eta_{\nu}$ は放射率, χ_{ν} は吸収係数, σ_{s} は散乱係数である. この ままだと式が閉じないため, テンソル P_{ν} を Eddington テン ソル \mathbf{f}_{ν} を用いて $P_{\nu} = \mathbf{f}_{\nu}E_{\nu}$ と表すようにする. 輻射場が等 方的であれば $\mathbf{f}_{\nu} = (1/3)\mathbf{I}$ となる. \mathbf{I} は単位テンソルである. 等方的な輻射場 $\mathbf{f} = (1/3)\mathbf{I}$ を仮定し, さらに $\frac{\partial F_{\nu}}{\partial t} = 0$ とする と最も簡単な拡散近似における輻射輸送の式を導出するこ とができる.

$$\frac{\partial E_{\nu}}{\partial t} + \nabla \cdot (D_{\nu} E_{\nu}) = 4\pi \eta_{\nu} - c \chi_{\nu} E_{\nu}.$$
(17)

ここで, $D_{\nu} = \frac{c}{3\chi_{\nu}}$ である.しかしながら, 輻射場を等方的

と仮定したために,非等方的な極限ではエネルギー流束を 正確に評価することができない.そのため,電子熱伝導の 時と同様に,非物理的な解を避けるための熱束制限を行 う.輻射の場合には $F_{\nu} = cE_{\nu}$ が自由エネルギー流束となる から,完全等方的な輻射場を仮定したエネルギー流束 qと調和平均をとることにより,

$$D_{\nu} = \frac{c}{3\chi_{\nu} + \frac{|\nabla E_{\nu}|}{E_{\nu}}},\tag{18}$$

とする.これにより,輻射場が等方的極限($|\nabla E|/E \ll 1$) と非等方極限の両極限で物理的に正しい解を得ることがで きる.このモデルは熱束制限拡散近似(Flux-limited diffusion approximation)とよばれ,簡便であるが,ほどほどの 精度で計算できるとして広く使われている.

また,輻射輸送方程式の右辺に用いる放射率 (emissivity),吸収率 (absorption coefficient) は輻射輸送を解く際 に非常に重要であるが,ここでは割愛する.文献[12]に詳 しい記述がある.

3.3.7 レーザー吸収

レーザーを金属に照射すると、レーザーは臨界密度 (critical density) までしか伝播しない. z方向に伝播する直 線偏光のレーザー電場をE(z) は

$$\frac{\partial^2 E(z)}{\partial z^2} + \frac{\varepsilon(\omega, z)\omega^2 E(z)}{c^2} = 0,$$
(19)

のヘルムホルツ方程式に従う. ここで ω はレーザーの(角) 周波数, $\epsilon(\omega, z)$ は誘電関数である. z > 0 を金属とすると, 電場 E(z) は金属表面 Z = 0 で E(z = 0) として,

$$E(z) = E(0) \exp\left(-\frac{z}{\delta}\right), \qquad (20)$$

で減衰する.ここで、金属における電場の侵入深さ、即ち スキン長 δ は $\delta = i \frac{1}{\varepsilon^{1/2} \omega} c$ となる.プラズマの誘電関数は

$$\varepsilon = 1 + \frac{4\pi\sigma}{\omega} = 1 - \frac{\omega_{\rm pe}}{\omega(\omega + i\nu)}$$
$$= \varepsilon_1 + i\varepsilon_2 \tag{21}$$

$$=\left(1-rac{\omega_{
m pe}^2}{\omega_{
m pe}^2+
u^2}
ight)+i\left(rac{
u\omega_{
m pe}^2}{\omega^{3+}
u^2\omega}
ight),$$

である. ここで ω はレーザーの周波数, ω_{pe} はプラズマ周波数, ν は電子の衝突周波数である. これからスキン長 δ は $\nu/\omega \ll 1$ かつ $\omega/\omega_{pe} \ll 1$ のときに

$$\delta = \frac{c}{\omega_{\rm pe}},\tag{22}$$

となる. 複素屈折率 $\tilde{n} = \sqrt{\epsilon} = n + ik$ を考えると

$$n = \sqrt{\frac{\varepsilon_1 + \sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2}}{2}}, \qquad (23)$$

$$k = \sqrt{\frac{-\varepsilon_1 + \sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2}}{2}}, \qquad (24)$$

となり、これからターゲット表面における反射率 R が求まる.

$$R = \frac{(n-1)^2 + k^2}{(n+1)^2 + k^2} \,. \tag{25}$$

ここからレーザーの吸収率 α は $\alpha = 1 - R$ によって

$$\alpha = 1 - R = 1 - \frac{(n-1)^2 + k^2}{(n+1)^2 + k^2} = \frac{2k^2}{(n-1)^2 + k^2}, \quad (26)$$

と見積もることができる[20].また、ターゲットの加熱 $Q_L(z,t)$ は

$$Q_{\rm L}(z,t) = \frac{1}{2} Re\{\sigma(z,t)\} |E|^2, \qquad (27)$$

でありターゲット表面におけるレーザー強度をI(z=0,t)とすると

$$Q_{\rm L}(z,t) = b\alpha I(z=0,t)\exp\left(-bz\right),\tag{28}$$

となる[21]. ここで $b = 4\pi k/\lambda$ で、 λ はレーザーの波長である.

加熱されたターゲット表面が噴き出して比較的低密度気 体/プラズマが生成されるとレーザーの臨界密度以下の状 態が現れる.そこでは逆制動放射によってレーザーが吸収 される.逆制動放射は自由電子が中性原子やイオンなどに より散乱される際に光を出す制動放射の逆過程である.電 子-中性原子との衝突における吸収係数 κ^{en} は

$$\kappa_{\rm IB}^{\rm en} = \left[1 - \exp\left(-\frac{h\nu}{k_{\rm B}T_{\rm e}}\right)\right] \sum_{j} Q_{j} n_{\rm e} n_{j}, \qquad (29)$$

で与えられ[22,23], jは中性粒子の種別, Q_j は電子が j原子と衝突する間に光を吸収する断面積であり, 10^{-36} cm⁵のオーダーである. n_j は中性原子の数密度であ る.電子とイオンの衝突による逆制動放射吸収係数 $\kappa_{\rm E}^{\rm ei}$ は

$$\kappa_{\rm IB}^{\rm ei} = \left[1 - \exp\left(-\frac{h\nu}{k_{\rm B}T_{\rm e}}\right)\right] \frac{4e^6\lambda^3}{3hc^4m_{\rm e}}$$
(30)

$$\times \left(\frac{2\pi}{3m_{\rm e}k_{\rm B}T_{\rm e}}\right)^{1/2} n_{\rm e} \sum_i z_i^2 n_i g_i ,$$

で、 $z_i \ge n_i$ はイオンの価数と密度、 λ はレーザーの波長、 g_i はガウントファクターである.

3.4 逆制動放射の電子密度スケール長依存性

レーザー光の吸収の問題はレーザープラズマ応用におい て重要である。例えば EUV 光源ではレーザーのエネル ギーをプラズマに吸収させ, EUV 発光として取り出す が,レーザーから EUV 光への高い変換効率が求められる ため、レーザー吸収率が十分高いことが不可欠である。ア ブレーションプラズマの密度分布をn(x) = n_{crit} exp(-x/L) と仮定する。ここで n_{crit} は臨界密度であり、レーザー波長 によって決まる。L は電子密度のスケール長である。真空 側よりレーザーが入射し、伝播するに従い、プラズマの密 度上昇とともに、レーザー吸収量は増加する。レーザー光 は臨界密度まで到達すると反射され、真空側へと跳ね返 り、再びエネルギーをプラズマに付与しながら真空側へと 戻っていく。逆制動放射を仮定して全体の吸収率 a_{abs} を

$$\alpha_{\rm abs} = \frac{I_{\rm in} - I_{\rm out}}{I_{\rm in}} = 1 - \exp\left(-\int_0^L \kappa_{\rm IB} dz\right) \tag{31}$$

として定義する.ここで I_{in} , I_{out} はそれぞれ, プラズマに入 射するレーザー強度,吸収されずプラズマから反射されて 出て行く際のレーザー強度である. $n_e = 0$ から n_{crit} まで積 分すると

$$\alpha_{\rm abs} = 1 - \exp\left\{-\frac{8}{3} \frac{\nu_{\rm ei}(n_{\rm crit})L}{c}\right\}$$
(32)

となる[25]. ここではレーザーはターゲット面に対して垂 直に入射するものとした. 斜め入射の場合は垂直軸から θ だけ斜めに入射したとするとレーザー光は臨界密度 n_{crit} まで到達できなくなり, $n_e = n_{crit} \cos^2(\theta)$ までしか入射し なくなる. 局所的な逆制動放射の吸収率は密度の2乗に比 例するから臨界密度が低下すると吸収率も減少する. その ため, 平板ターゲットにレーザーを入射するのと球ター ゲットを照射するのではレーザーの吸収率は大きく異な る.

またレーザー吸収率はレーザー波長に大きく依存する. 図2にNd:YAGレーザー(波長1.06 μ m)と, CO₂レーザー (波長10.6 μ m)をの吸収率をスケール長*L*と電子温度の関数としてプロットする.

図2より,Nd:YAGに比べ,CO₂レーザーは極端にレー ザーの吸収率が低いことが見て取れる.これはNd:YAG に比べて臨界密度n_{crit}が2桁小さいためである.そのため, CO₂レーザーで充分なレーザー吸収を得ようとすると,ス ケール長Lを増加させるしかない.一次元の等温膨張を仮 定すると,スケール長Lは音速と膨張時間の積で決まるた め,レーザーのパルス幅を増加させると増加する.即ち, ロングパルスの方がレーザー吸収率は増大しやすいと考え られる.しかしながら,実際には一次元膨張と見なせる



図 2 Nd:YAG レーザーと CO_2 レーザーのレーザー吸収率のス ケール長依存性. 温度は $T_e = 50 \text{ eV}$ に設定した.

(プラズマの膨張サイズ)≪(レーザーのスポットサイズ) が成立するのは比較的短いレーザーパルスに限られ,ロン グパルスでは1次元円柱的な膨張ではなく、3次元球のよ うにプラズマは広がる.そのためレーザーパルスを増加さ せてもスケール長Lが増加しにくくなる.次世代の半導体 リソグラフィー用の光源して開発が進んでいる EUV 光源 ではメインのレーザーとして CO₂ レーザーを用いるた め、吸収率を増加させるために、別のレーザーで長いス ケール長Lのプラズマを生成してからCO₂レーザーを照射 するダブルパルス照射が考案されている[26].

3.5 電子熱伝導と輻射輸送の組み合わせ

高い原子番号を持つ物質では一般的により多くの光が放 射されるために電子熱伝導よりも輻射によるエネルギー輸 送が支配的になる.輻射の平均自由行程は電子よりも長く なる事が多い.そのため,低い原子番号の物質,例えばプ ラスチック等に高い原子番号の物質を微量添加し,より高 密度領域に吸収されたエネルギーを運ばせるようにするこ ともできる.図3にプラスチックターゲットの例を示す. 右からレーザーをターゲットに照射するとアブレーション プラズマが真空側に膨張する.これは電子熱伝導によりア ブレーションが駆動される例である.

次にプラスチックに微量(原子数比3%)の臭素(Br)を 添加したターゲットにレーザーを照射すると図4のように アブレーションが2段階で生じる.まず,レーザーエネル ギーが臨界密度付近で吸収され,吸収されたエネルギーが 電子熱伝導により運ばれる.加熱されたプラズマ中の臭素 が多くの輻射を出し,輻射によってエネルギーがより高密 度方向に運ばれる.これにより左側のアブレーションフロ ントが高密度側に形成される.このアブレーションは輻射 によって駆動されている.

この2段階アブレーション構造全体をダブルアブレー ション構造と呼ぶ.2段階の密度構造をもつダブルアブ レーション構造はここの例のように高Z物資を添加する場 合だけでなく、中~高Zのターゲットにナノ秒のレーザー



図3 プラスチック(CH)ターゲットに右から波長 0.53 μmの レーザーを照射した際の密度ρ,イオン温度 Τ_i,電子温度 T_e,輻射の輝度温度 T_r分布[27].



図4 臭素を原子数比3%添加した臭素化プラスチックターゲットに右から波長0.53µmのレーザーを照射した際の密度ρ, イオン温度 T_i,電子温度 T_e,輻射の輝度温度 T_r分布[27].

を照射すると形成される.図4の斜線部分(2つのアブ レーション間の距離)は時間的に発展する.レーザー核融 合ではこのダブルアブレーション構造を流体不安定性の抑 制に用いる研究が進んでいる[27].また,レーザー加速な ど薄膜をターゲットを用いる実験でも,超高強度レーザー のプリパルスによってダブルアブレーション構造が出現す ることが計算で確認されている[28].

3.6 まとめ

レーザープラズマの初期プラズマ生成からその後の時間 発展に至るまでの計算に必要な物理モデルを簡潔に述べ た.輻射輸送における輻射の放射率,吸収率や状態方程式 で原子過程がきわめて重要になるが,本章ではほとんど割 愛した.また工学的応用で重要になるレーザー吸収率の問 題と,輻射を用いたアブレーション構造の制御について記 述した.レーザープラズマ相互作用における初期プラズマ 生成のモデルは改良が続けられており,今後さらに精度が 上がっていくと思われる.

参考文献

- [1] S. Eliezer and Y. Eliezer, *The Fourth State of Matter* (IOP Pub., 2001).
- [2] 三上勝太, "光学材料レーザー損傷の温度依存性に関す る研究"博士学位論文(大阪大学大学院工学研究 科., 2013).
- [3] L.V. Keldysh, Soviet Physics JETP 20, 1307 (1965).
- [4] V.S. Popov, Physics-Uspekhi 47, 855 (2004).
- [5] L.J. Radziemski and D.A. Cremers, *Laser-induced plasmas and applications* (Marcel Dekker Inc., 1989).
- [6] S.I. Anisimov et al., Soviet Physics JETP 39, 375 (1974).
- [7] S. Elezer, The interaction of high-power lasers with plasmas
- (Institute of Plasma Physics Pub., 2002). [8] R.M. More *et al.*, Phys. Fluids **31**, 3059 (1988).
- [9] S.P. Lyon and J.D. Johnson, Los Alamos National Laboratory Tech. Rep. No. LA-UR-92-3407 (1992).
- [10] http://riodb.ibase.aist.go.jp/TPDB/DBGVsupport/
- [11] D. Saltzmann, *Atomic Physics in Hot Plasmas* (Oxford University Press, 1998).
- [12] 浜口智志他:プラズマ・核融合学会編『プラズマ原子 分子過程ハンドブック』第9章,第10章,第14章(大阪 大学出版会,2011)
- [13] H.W. Drawin and P. Felenbok, Data for plasmas in local

淳

公益財団法人レーザー技術総合研究所理 論・シミュレーションチーム研究員.大阪 大学大学院工学研究科博士後期課程修了. 博士(工学).専門はレーザー核融合や極

すな砂

値シミュレーション.

原

端紫外光源プラズマなど、レーザー生成プラズマの理論・数

thermodynamic equilibrium (Gauthier-Villars., 1965).

- [14] R. Ramis *et al.*, Computer Physics Communications 183, 637 (2012).
- [15] K. Eidmann et al., Phys. Rev. E 62, 1202 (2000).
- [16] P.S. Shternin and D.G. Yakovlev, Phys. Rev. D 74, 043004
 -1-8 (2006).
- [17] C. Kittel:キッテル固体物理学入門 第8版 (丸善, 2005).
- [18] L. Spitzer Jr., 完全電離気体の物理 Physics of Fully Ionized Gases (コロナ社, 1963).
- [19] 大西直文: プラズマ・核融合学会誌 88,467 (2012).
- [20] 新井武二:レーザー加工の基礎工学(丸善, 2006).
- [21] R. Fang et al., Materials Transactions 51, 1156 (2010).
- [22] X.L. Mao et al., J. Appl. Phys. 74, 4915 (1993).
- [23] A. Bogaerts and Z. Chen, Spectrochimica Acta Part B 60, 1280 (2005).
- [24] B. Wu and Y.C. Shin, J. Appl. Phys. 99, 084310-1-8 (2006).
- [25] W.L. Kruer, *The Physics of Laser Plasma Interactions* (Frontier in Physics., Westview press, 2003).
- [26] K. Nishihara et al., Phys. Plasmas 15, 056708-1-11 (2008).
- [27] S. Fujioka et al., Phys. Rev. Lett. 92, 195001-1-4 (2004).
- [28] A. Sunahara and K.A. Tanaka, Fusion Eng. Des. 85, 935 (2010).

講座 レーザー生成プラズマの新しい温度,密度領域における物性とシミュレーション

4. 固体物性からみたレーザーアブレーション

4. Laser Ablation: From the Viewpoint of Solid State Physics

 富田卓朗 TOMITA Takuro 徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 (原稿受付:2013年5月21日)

三次元微細加工や非熱加工など,他の加工法にはない独特の加工技術としてフェムト秒レーザーアブレーションが注目を集めているが,その基礎的な物理過程はほとんどわかっていないのが現状である.また,フェムト秒レーザー照射は非常に短い時間(~100 fs)で非常に高いエネルギー(~10⁹ J/cm³)を微小な領域(~1 µm³)に注入できる唯一の手法であることから,局所的に高温度・高密度状態を生成する手段として利用できる可能性もある.そこで,本章では,フェムト秒レーザー照射によって自発的に固体表面に形成されるレーザー誘起ナノ周期構造や,フェムト秒レーザー照射による物性改質,また,フェムト秒レーザー照射によって誘起される衝撃波と,それに伴う残留応力について,最近の研究成果を紹介するとともに,これらの結果からレーザー生成プラズマの新領域開拓についての展望を述べる.

Keywords:

femtosecond laser ablation, Coulomb explosion, laser-induced nanostructure, Raman spectroscopy, transmission electron microscopy, high density plasma, shock wave, warm dense matter

4.1 レーザーアブレーションの歴史的背景

レーザーアブレーションとは、レーザー照射により固体 材料表面が切断,除去,変形,改質される現象のことであ り、1960年の Maiman[1]によるルビーレーザー発明後,ま もなくの1962年に Breech と Cross[2]によってメリーラン ド大学における分光学の国際会議で初めて発表された.そ の後,穴あけ,切断から,表面における自発的構造形成な どの形態変化に留まらず,レーザー照射による物性改質な どに至るまで様々な現象が報告されるようになった[3-5]. アブレーションに用いるレーザーとしては1990年頃までは 連続波やナノ秒のパルスレーザーを用いた研究がほとんど であり,その加工・改質過程は二温度モデルなどの熱的な プロセスで説明されてきた.

一方,1990年代に入ると自己モード同期とチャープパル ス再生増幅法による高強度フェムト秒レーザーが市販され るようになり,フェムト秒レーザーを用いた加工・改質が 注目を集めるようになった.フェムト秒レーザーは数 fs~ 数 100 fs(フェムト秒)の時間幅で強力な光パルスを発生 することのできるレーザー光源であり,再生増幅システム を使用することでテーブルトップクラスのレーザーでも mJ(ミリジュール)クラスの高強度なフェムト秒パルスを 容易に発生することができる.この強い光電場を用いるこ とで物質の化学結合を非熱的に切断することが可能にな り,フェムト秒レーザー加工という新しい応用分野が開拓 されつつある[6,7]. また、フェムト秒レーザー光照射では、光によって励起 された電子エネルギーが格子に緩和するよりも早く、光照 射が完了するため、強い光照射によって、高温度・高圧力 状態をつくり出すことが可能である.このフェムト秒レー ザー照射によってつくり出される過渡的な状態は固体密度 (ガラスを例にとると 2~3 g/cm³) 程度で数千 K の高温に 達することもある.この状態はプラズマ物理学における warm dense matter (WDM)状態に迫るものであり、巨大 惑星内部の状態に匹敵する[8,9].つまり、フェムト秒レー ザー照射は惑星内部における物質状態を模擬する手段とし て用いることができる可能性があり興味深い.

そこで、本章では、フェムト秒レーザー用いた加工・改 質法について述べるとともに、その基礎過程およびレー ザープラズマとの関連およびその将来展望について述べ る.

4.2 フェムト秒レーザーアブレーションによる 非熱的加工

フェムト秒レーザー加工がナノ秒や連続波のレーザー加 工と大きく異なる点の一つは、パルス幅が非常に短い(~ 100 fs)ため、レーザー照射中の熱拡散が非常に小さいとい うことである.レーザーアブレーションに伴う詳細な熱拡 散の解析は他の文献[10]に詳しく書かれているので詳細は 割愛し、ここでは、パルス時間幅の間に起こる熱拡散長を フェムト秒とナノ秒のレーザーを例にとって比較する.

Faculty of Engineering, The University of Tokushima, TOKUSHIMA 770-8506, Japan

author's e-mail: tomita@tokushima-u.ac.jp

一般に, 拡散長 l_{diff} は, κ を拡散係数, τ をレーザーのパ ルス幅とすると,

 $l_{\rm diff} = \sqrt{2\kappa\tau}$

で与えられる.たとえば、室温における鉄の拡散係数κは、 2.3×10⁻⁵ m²/s 程度であるので, 拡散長 l_{diff} は 100 fs のパル ス幅では 2.1 nm, 10 ns のパルス幅では 0.68 µm となる. し たがって,熱によって変質される領域はフェムト秒レー ザーの方が約2桁も小さいことになる.他の物質において も拡散係数によって拡散長は異なるが、フェムト秒レー ザーの方で拡散長が約2桁小さいことは基本的には変わり がない.また、フェムト秒レーザーによる拡散長(2.1 nm) はフェムト秒レーザーを用いた最小加工サイズ(~ 200 nm)に比べて十分に小さいので、実質的にはフェムト 秒レーザー加工における熱的な影響は無視できる[10]. た だし注意しておきたいのは、フェムト秒レーザー加工でも 熱的影響が無視できない場合もあるということである. こ こで述べた状況はフェムト秒レーザー照射によって材料除 去が速やかに行われることを仮定しており, 照射強度や照 射フルエンスの空間分布を適切に選択しないと熱影響は小 さくできない.一般に、熱影響は照射強度が強すぎても弱 すぎても大きくなるため、その中間の適切な領域を選択す ることが熱影響の少ない加工を実現するためには必須であ る.

一方で、フェムト秒レーザーを用いた加工においては熱 拡散の抑制のみならず、加工プロセスそのものにもナノ秒 や連続波のレーザーによるプロセスとは大きな違いがあ る.図1に示すように、ナノ秒や連続波のレーザーにおい てはレーザー被照射部が加熱され、蒸発することにより材 料の除去が起こる。それに対し、フェムト秒レーザーにお いては、クーロン爆発と呼ばれる光励起によって生じる原 子間結合の直接的な切断によって材料の除去が起こる。具 体的には、フェムト秒レーザー光のような強い光電場が固 体表面に入射すると、原子間の結合に関与する電子が直接 剥ぎ取られる。残されたイオンはクーロン力によって反発 し、固体表面から飛散する。通常、ナノ秒や連続波の加工 では電子励起のあと、電子格子相互作用を通じて、熱エネ ルギーが格子に伝達されることで加工周辺部への熱影響を 生じるが、クーロン爆発によるアブレーションは、ピコ秒



図1 ナノ秒や連続波 (CW) レーザーによるレーザーアブレー ションとフェムト秒レーザーアブレーションの違い.

以下の時間領域で起こるので,格子へのエネルギー緩和が 起こるよりも早く被照射部の除去が起こり,周囲への熱影 響がほとんど生じない.このように,クーロン爆発は, フェムト秒レーザーに特有の高光電場下のみで起こるアブ レーションプロセスの一つである[11].これらのことか ら,フェムト秒レーザー加工が非熱的加工と呼ばれている ゆえんである.フェムト秒レーザーによる非熱的加工の一 例として,参考文献[12]に挙げるホームページの画像が興 味深い.この画像によると,フェムト秒レーザー照射に よってマッチ棒の先端部(火薬部)が発火することなく切 断できている.それに対し,フェムト秒レーザー照射以外 のレーザー照射では,マッチ棒の先端部は発火してしま う.これは,フェムト秒レーザーが通常の加工法と比べて, 加工部周辺にほとんど熱影響を与えない加工法であること の好例である.

4.3 レーザー誘起ナノ周期構造

レーザー誘起ナノ周期構造は通称"リップル構造"と呼ばれ1965年にBirnbaumがルビーレーザーの光をゲルマニ ウム表面に照射することで発見した[13].リップル構造は 一般に光の電場方向に垂直に形成され,周期は照射レー ザーの波長にほぼ等しいことが知られていた.リップル構 造の生成メカニズムについては理論,実験の両面から活発 に研究がなされ,1980年代前半頃にはSipeらによって入射 光と固体表面からの散乱光,および表面電磁波との干渉に よって発生するとする説が提唱され,幅広く受け入られて いる[14-17].このモデルによると,形成されるナノ周期 構造の周期は,

$$\Lambda = \frac{\lambda}{1 \pm \sin \theta}$$

となる. ここで, A は生成されるナノ構造の周期, A は入射 レーザー光の波長, θ はレーザーの入射角である.分母の ±は,半導体ではプラスをとり,金属ではマイナスをとる ことが知られている.具体的には,半導体ではリップル構 造形成中にサンプル表面で前方散乱が起こることで,光入 射方向と同方向に表面電磁波が伝搬する.一方で,金属で はリップル構造形成中にサンプル表面で後方散乱が起こる ことで,光入射方向と逆方向に表面電磁波が伝搬する [5,18].

しかし,近年のフェムト秒レーザーの照射実験により, このモデルでは説明できない照射波長の数分の一(1/2以 下)の周期をもつリップル構造が数多く報告されてきてい る[19-21].レーザー加工分野では,レーザーの波長程度の 周期をもつリップル構造のことを"粗いリップル構造 (coarse ripple)",フェムト秒レーザー照射特有の波長の 数分の一の周期をもつフェムト秒レーザー照射特有のナノ 周期構造のことを"細かいリップル構造(fine ripple)"と 呼んでいる.図2に我々がフェムト秒レーザー照射によっ て単結晶シリコンカーバイド(SiC)上に作製したリップ ル構造の走査型電子顕微鏡像を示す.照射に用いたフェム ト秒レーザーの波長は800 nm,照射パルスエネルギーは



図 2 フェムト秒レーザー照射したSiC表面の走査型電子顕微鏡像

 (a)粗面化していない(Ra:0.0002 m)基板上のナノ周期構造.
 中心部に粗い(~500 nm)周期構造のみが観測される.
 (b)粗面化した(Ra:0.005 m)基板上のナノ周期構造.
 中心部の粗い周期構造に加え、周辺部に細かい(~250 nm)周期構造も観測される.
 (参考文献[23]より)

3µJ,照射パルス数50である.粗いリップル構造が中心部, 細かいリップル構造が周辺部に形成されており、照射レー ザー光のビームプロファイルはガウス型をしていることか ら、各リップル構造が局所フルエンスに応じ、明確な境界 をもって形成されていることがわかる[22]. さらに,図2 (a)は初期表面粗さ(Ra)が0.0002 µm(平坦な試料),図2 (b)は初期表面粗さが0.005 µm(粗い試料)のSiCに対して 照射したものであるが、粗い試料上へは細かいリップル構 造が大面積でできているのに対し、平坦な試料上へは細か いリップル構造がほとんどできていない.一方で、粗い リップル構造の形成面積は両方の試料でほぼ同じ、すなわ ち粗いリップル構造の形成閾値は初期表面粗さの影響を受 けないことがわかる.このことから、細かいリップル構造 の形成は、表面凹凸によるポテンシャル変調の影響によ り、光励起キャリアが局在化するためであることが示され たが、その詳細な過程は明らかになっていない[23].ま た,これまでは複数パルスの照射がリップル構造形成に必 須であると考えられていたが、必ずしもそうではないこと がシリコン基板へのフェムト秒レーザー照射によって明ら かになっている[24].

このように、細かいリップル構造の生成については特に 活発に議論が行われており、様々なモデルが提唱されてい るがいずれも統一的な理解に至ってはいない.現在,議論 されているモデルとしては,

1. 自己組織化モデル[25-27]

- 2. パラメトリック緩和モデル[28]
- 3. 表面プラズモンモデル[29,30]

などがある.これらの詳細については,各参考文献に譲る が,以下にそれぞれの特徴を簡潔に示す.

1のモデルにおいては、フェムト秒レーザー照射によっ

て生じる非平衡状態から緩和する際に自己組織化が起こる とするものである.イオンスパッターにおいてもフェムト 秒レーザー照射と同様の構造が生じることから[31],フェ ムト秒レーザー照射におけるナノ構造生成についても同じ メカニズムによるものであるとしている.しかし,フェム ト秒レーザー照射に伴う自己組織化現象が具体的にどのよ うな物理的過程によって生じているかは明らかにされてお らず,今後明らかにすべき課題も多い.

次に,2のパラメトリックモデルにおいては,入射レー ザー光が表面プラズマ波にパラメトリック緩和する過程を 考慮することによってフェムト秒レーザー照射による周期 構造形成を説明するモデルで,特定の強度範囲ではこのモ デルで説明できることがわかっている.しかし,ナノ周期 構造の形成ダイナミクスをどのように説明するかなどの問 題点も残されている.

3の表面プラズモンモデルでは、フェムト秒レーザー励 起によって固体表面に表面プラズモンポラリトンが生成さ れ、それが周期的構造形成に繋がるとするものである.こ のモデルも、精力的に検討され、計算と実験的とのよい一 致が見られているが、強励起領域での分岐(bifurcation) 現象などこのモデルでは説明が難しい実験事実もあり、今 後の解明が期待される.

最後に、レーザー波長程度の周期をもつナノ周期構造で も、古典的な干渉モデルで説明できないものが報告されて きており[32]、レーザー誘起ナノ周期構造の生成メカニズ ムに関する議論は今後も活発に続くものと予想される.

4.4 フェムト秒レーザー照射による物性改質

ここまではフェムト秒レーザーを加工閾値近傍の強度で 照射した場合の表面形状変化について説明してきた.フェ ムト秒レーザー照射に伴って形状のみならず物性の変化も 起こることがよく知られている.また,フェムト秒レー ザーアブレーション過程を理解するためには表面形状のみ ならず物性の観点からのアプローチも重要である.しか し,これまで,フェムト秒レーザー照射に伴う物性変化を 議論した研究は形状変化を議論した研究と比較して非常に 少なかった.その中で,我々は,共焦点顕微ラマン分光シ ステムと透過型電子顕微鏡観察を用いてレーザー誘起ナノ 周期構造の物性分析を行ったのでその結果を紹介する.

ラマン散乱の励起光源としては波長 488 nm の半導体 レーザーを用い, 測定系の空間分解能は約 1 μm であった. ラマン測定の結果, 図3 (a)に示すように粗いリップル構 造上で単結晶 4H-SiC のピークに加え, 矢印で示す位置に, アモルファスシリコン(a-Si), アモルファス炭素(a-C)の D バンドおよび G バンド, アモルファスシリコンカーバイド (a-SiC)のピークが確認できた. さらに, 細かいリップル構 造上でも粗いリップル構造と同様に, 単結晶 4H-SiC, a-Si, a-C, a-SiC のピークが確認できた. また, 粗いリップル構 造と比較すると細かいリップル構造でアモルファス相から の信号がより強いことが明らかになった[33]. このアモル ファス相の深さ方向の分布を議論するため透過型電子顕微 鏡を用いた観察を行った. その結果, アモルファス相の厚 さは数10 nmでナノ周期構造の表面に沿ってほぼ一様に分布し、それより内部では単結晶のSiCのみが観測された[34].

また,SiC以外の材料においても,同様の傾向は観測さ れている.井澤らは,図4に示すように,シリコンにピー クフルエンス0.21 J/cm²でフェムト秒レーザーパルスを20 発照射した断面の透過型電子顕微鏡観察を行った.この結 果から,フェムト秒レーザー照射部に数10 nm 程度の均一 なアモルファス層が生成されていることがわかる.特に, このアモルファス層の厚さは照射レーザーフルエンスや照 射パルス数にほとんど依存しなかったということは注目に 値する.これらの結果から,フェムト秒レーザー照射に伴 う表面のアモルファス化や相分離現象は単結晶SiCに限っ た現象ではなく,シリコンなどの他の物質でも観測される フェムト秒レーザー照射によって普遍的に起こる現象と考 えられる[35].



図3 (a)フェムト秒レーザー照射した SiC 基板表面のラマンスペクトル(Fine:細かいリップル構造, Coarse:粗いリップル構造, Non-irradiated:未照射部).
 (b)フェムト秒レーザー照射によって引き起こされる相分離の概念図(参考文献[33]および[34]より).



図4 単結晶シリコン表面にピークフルエンス 0.21 J/cm² でフェムト秒レーザーパルスを20発照射した断面の透過型電子顕微鏡像(参考文献[35]より).

さらに,我々はフェムト秒レーザー照射によって引き起 こされる物性改質を局所電気伝導度制御技術に展開する研 究も開始している[36]. 図5にシリコンカーバイドの電極 間にフェムト秒レーザー光を照射して改質した部分の抵抗 を測定した結果を示す.照射フルエンス5.0 J/cm²から 6.7 J/cm²において抵抗値が二桁以上も劇的に変化してい ることがわかる.このような不連続な抵抗値の変化は図3 において述べたフェムト秒レーザー照射に伴う相分離との 関連からも興味深い.さらに,フェムト秒レーザー照射に 特有の内部加工(改質)技術と,フェムト秒レーザー照射 に伴う電気伝導特性変化を上手く組み合わせれば,フェム ト秒レーザー照射による半導体の三次元回路作製技術に繋 がる可能性もあり,今後の発展が期待できる.

4.5 フェムト秒レーザーを用いた透明材料の内 部加工

フェムト秒レーザー照射に特徴的な現象として、前述の 非熱的加工に加え,透明材料内部の加工が挙げられる. フェムト秒レーザー光は非常に強い光電場、すなわち高い 光子数密度をもった光であるため、集光部において、多光 子吸収が発生する.多光子吸収によって伝導帯に生成され た電子は、光電場によって加速され、アバランシェイオン 化を引き起こす[37].アバランシェ過程による大量の電子 生成によって、結晶格子が不安定になり、透明材料内部で 空洞化や,物性改質を引き起こす.ここで,再度強調して おきたいことはフェムト秒レーザー照射による内部加工・ 改質は集光部を材料内部に調整し,適切な照射条件を選択 すれば「表面に影響をまったく与えることなく」、「透明固 体材料の内部を三次元的に加工・改質可能」であるという ことである.このことを活かし、フェムト秒レーザーを用 いた感光性樹脂の三次元造形[38]や、フェムト秒レーザー 支援エッチング[39]等が活発に研究されている。

また,我々は単結晶 SiC の内部にフェムト秒レーザー照 射を行い,被照射部の断面 TEM 観察およびラマン分光計



図5 フェムト秒レーザー改質部における電気抵抗の照射フルエ ンス依存性(参考文献[36]より).

測を行った[40,41]. 図 6 (a)に示すように,サンプル表面 からフェムト秒レーザー内部に集光照射し,照射点をライ ン状に走査することで直線状の改質部を数本作り,そのう ちの一本の断面を観察した. 図中では光の進行方向を*k*, 光電場の方向を*E*,観察方向を目で示している. 図 6 (b)は この改質部の透過型電子顕微鏡像であり,フェムト秒レー ザーを SiC 内部に集光照射した部分において I から V に示 すような 5 つのグループに別れて光の進行方向に改質部が 存在していた. さらに,それぞれの改質部の中には 150 nm と 300 nm の周期をもった歪み構造が周期的に分布してお り,この歪の方向は光電場に平行であった. この内部周期 構造は Taylor らによって報告されているナノプラズマモ デルによって説明できる可能性があり現在検討を進めてい る[42,43].

この改質部周辺において顕微ラマンによるマッピング測 定を行ったところ,782.5 cm⁻¹に観測される SiC の縦波光 学フォノンモードに対応するピークにシフトが観測された (図6(c)).このピークシフトから,フェムト秒レーザー 照射による SiC の内部改質部には,最大で1.4 GPaの圧縮応 力,もしくは最大で0.4 GPa の引張応力が残留応力として 働いていることが明らかになった.また,ラマンピークの 幅も図6(d)に示すように広がっていることから,応力の 分布(偏り)があることも明らかになった.これらの残留 応力はフェムト秒レーザー照射によって引き起こされる衝 撃波の痕跡であるものと考えられる.

衝撃波そのものを観測する試みとして、早崎らは、可視 光のポンププローブイメージングによって、図6に示すよ うな、フェムト秒レーザー照射直後から周辺に広がる衝撃 波のイメージングに成功している[45].図7はガラスにパ ルスエネルギー50 nJ で 800 nm、45 fs のフェムト秒レー ザー光を照射後の様子を観察したもので、位相像(上段) と振幅像(下段)が得られている.この図からわかるよう に衝撃波は、フェムト秒レーザー光を照射後、同心円状に 拡がっていっている.最近では、フェムト秒レーザー光を 多焦点で照射し、衝撃波の伝搬形状を制御することで、 フェムト秒レーザー加工の新たな制御パラメータを導入す る試みも行われつつある[46].

4.6 内部照射技術を用いた高密度プラズマ生成 への期待

これまではフェムト秒レーザー照射によって固体表面お よび内部に生じる不可逆的かつ半永久的な変化を,主に終 状態,つまり現象が完了した状態から議論してきた.本節 では,これらの結果を踏まえ,フェムト秒レーザー照射に よって過渡的に生じる物質状態について議論を行うととも に,過渡状態を直接捉える試みについて紹介する.

フェムト秒レーザー照射後,光吸収や impact ionization によってキャリアが励起される.励起されたキャリアは キャリア・キャリア散乱(電子・電子散乱など)やキャリ ア・フォノン散乱(電子・格子相互作用など)を経て, オージェー再結合や輻射再結合,またはキャリア拡散等に よって,キャリアそのものが消滅するか,もしくはキャリ



(1100]

図6 (a)フェムト秒レーザー内部改質部における物性評価の概念図.kは光の進行方向,Eは光電場方向であり、サンプル断面に数本のライン状改質部を作製した.その断面を目の方向から観察した((b)-(d)).
(b)SiC内部へフェムト秒レーザー照射を行った箇所の透過型電子顕微鏡像、IからVに示すような5つのグループに別れて光の進行方向に改質部が存在していた(光は紙面の上から下に入射し、光電場は紙面に垂直である).
(c)(b)と同部分におけるラマンピーク位置.
(d)(b)と同部分におけるラマンスペクトル幅(参考文献[41]より、観測の概念図は参考文献[44]から引用).



図7 t = (a) 0.5 ps, (b) 1 ps, (c) 70 ps, (d) 250ps, (e) 500 ps におけるプローブパルスの位相(上段)および振幅像(下 段)パルスエネルギーは E = 50 nJ, イメージサイズは 8.3 μm×8.3 μm. (参考文献[45]より).

アが移動することによって励起領域から存在しなくなり, 被照射領域におけるキャリア密度が減衰する.また,励起 領域において,キャリア密度が減衰する途中で,前述した ようなアブレーションや熱拡散,再結晶化が生じる[47]. 特に,前節で述べた透明固体材料内部へのフェムト秒レー ザー照射においては、光吸収や impact ionization によって キャリアが励起されても内部であるため、原子や電子の飛 散が起こらず、エネルギーは散逸することができない、そ の結果、エネルギーが被照射領域に留まることで電子温度 が極めて高い状態になっている. その後, 電子エネルギー が格子エネルギーに変換され、高温度・高圧力状態が生じ る. 具体的には、サファイア結晶内部に 100 nJ, 800 nm, 200 fs のフェムト秒レーザーパルスを集光照射すると圧力 10 TPa, 温度5×105 K程度になっていることが予測されて いる[48].フェムト秒レーザー照射で生じる、このような 高温度・高圧力状態は warm dense matter (WDM) 状態よ り2桁程度密度が低いが、WDMに迫る状態といっても過 言ではないだろう. さらに, このような状況が実現する前 後での温度の上昇および下降率は10¹⁸ K/sと急速な加熱・ 冷却プロセスとなっていることも指摘されている[48]. こ の極限的な高温度・高圧力状態とそれに伴う急速な加熱・ 冷却プロセスは非常に小さな体積(~0.2 µm³)でかつ,非 常に短時間(~数10ps)の間しか存在しないが、それで も、このような高温度・高圧力条件を比較的簡便につくり 出せることの意義は大きい. また、フェムト秒レーザー照 射後の急速な冷却プロセスを経て常温常圧状態に戻る段階 で、高温相の凍結による新物質創成が起こる可能性もあり 興味深い.

上記のような理由からもフェムト秒レーザーアブレー ションダイナミクスの理解は重要であり、その過渡状態の 観測には様々な試みがなされている.特に,可視光をプ ローブとして用いた研究は比較的以前より行われている [49]. しかし, 可視光を用いたプローブではフェムト秒 レーザーアブレーションに伴うプラズマの噴出によって視 野が遮られてしまい、観測できる照射フルエンス領域が限 られてしまう. そこで, 我々は, 近赤外フェムト秒レー ザーポンプ・軟X線プローブの時間分解反射率イメージン グ,および干渉イメージング光学系を構築し、フェムト秒 レーザーアブレーションダイナミクスの観測を行なってい る.軟X線はレーザーアブレーションに伴うプラズマ噴出 に対してほぼ透明であるため、プラズマの影響を受けずに 固体表面を観測するのに適している[50].現在,我々はア ブレーションフロントの膨張や照射フルエンスに敏感に依 存して変化するアブレーション過程の観測に成功している [51]. 一方で,絶縁体[52],半導体[53]や金属[54]などに おけるフェムト秒レーザーアブレーションプロセスのシミュ レーションも近年活発に行われるようになってきた. この ように実験,理論の双方からの検討が進むことによって, フェムト秒レーザーアブレーションの新領域を切り拓き, 他分野との融合研究に繋がっていくものと期待している.

4.7 おわりに

本章では、フェムト秒レーザーアブレーションについ て、その特徴と今後の可能性について述べてきた.1章で はレーザーアブレーションの歴史的背景を、2章ではフェ ムト秒レーザーアブレーションによる非熱的加工について 述べた.また、3章では近年注目を集めているレーザー誘 起ナノ周期構造の生成について述べ、4章でそれらの物性 分析とフェムト秒レーザー照射を用いた能動的な物性改質 の可能性について述べた.最後に、5章でフェムト秒レー ザーに特有の内部照射技術を用いた改質と衝撃波の発生に ついて説明したあと、6章では内部集光照射による高密度 プラズマ生成への期待について述べる.

このようにフェムト秒レーザープロセシングへの期待は 急速に高まっている.一方で,フェムト秒レーザーアブ レーションプロセス,特に,フェムト秒レーザー照射に よって生じる高温度・高圧力状態とそこからの緩和過程に ついてはほとんど明らかにされていないのが現状である. これらを明らかにするためには,レーザー照射中や照射直 後におけるプラズマ状態の診断や,被照射材料が照射直後 の極限的な非平衡状態から平衡状態に緩和するまでの原子 状態に関する研究など,幅広い分野からの統一的な議論が 不可欠になるであろう.

参 考 文 献

- [1] T.H. Maiman, Nature 187, 493 (1960).
- [2] F. Breech and L. Cross, Appl. Spectroscopy 16, 59 (1962).
- [3] J.C. Miller, AIP Conf. Proc. 288, 619 (1993).
- [4] 電気学会編:レーザーアブレーションとその応用(コ ロナ社, 1999年).
- [5] D. Bäuerle, Laser processing and Chemistry (Springer, Berlin, 2000), 3rd ed.
- [6] 藤田雅之, 橋田昌樹:応用物理 73, 178 (2004).
- [7] 橋田昌樹他:応用物理 75,451 (2006).
- [8] 米田仁紀: プラズマ·核融合学会誌 81, Suppl. 172 (2005).
- [9] 米田仁紀: プラズマ・核融合学会誌 83,624 (2007).
- [10] 松尾繁樹:レーザープロセシング応用便覧(増原宏 編, NGT, 2006年) p. 385-393.
- [11] N.M. Bulgakova *et al.*, Laser Ablation and its Application, (C.R. Phipps eds., Springer, 2006) p.17.
- [12] 例えば, http://www.hokuhoku.ne.jp/rmec/16pdf/10. pdf
- [13] M. Birnbaum, J. Appl. Phys. 36, 3688 (1965)
- [14] J.E. Sipe *et al.*, Phys. Rev. B 27, 1141 (1983).
- [15] J.F. Young et al., Phys. Rev. B 27, 1155 (1983).
- [16] J.F. Young et al., Phys. Rev. B 30, 2001 (1984).
- [17] Yu. V. Vigant et al., Sov. Phys. JETP 64, 123 (1986).
- [18] 南 志昌,豊田浩一:レーザー研究 28,824 (2000).
- [19] N. Yasumaru *et al.*, Appl. Phys. A **76**, 983 (2003).
- [20] A. Borowiec and H.K. Haugen, Appl. Phys. Lett. 82, 4462 (2003).
- [21] P. Rudolph and W. Kautek, Thin Solid Films 453-454, 537 (2004).
- [22] T. Tomita et al., Jpn. J. Appl. Phys. 45, L444 (2006)
- [23] T. Tomita et al., Appl. Phys. Lett. 90, 153115 (2007)
- [24] T. Tomita et al., Appl. Phys. Lett. 92, 013104 (2008).
- [25] M. Henyk et al., Appl. Phys. A 69, S355 (1999).
- [26] J. Reif et al., Appl. Phys. A 92, 1019 (2008).
- [27] J. Reif et al., Phys. Stat. Solidi C 6, 681 (2009).
- [28] S. Sakabe et al., Phys. Rev. B 79, 033409 (2009).
- [29] G. Miyaji and K. Miyazaki, Appl. Phys. Lett. 91, 123102 (2007).

Lecture Note

- [30] G. Miyaji and K. Miyazaki, Opt. Express, 16, 16265 (2008).
- [31] P. Sigmund, J. Mater. Sci. 8, 1545 (1973).
- [32] T. Tomita et al., Appl. Phys. A, 105, 89 (2011).
- [33] M. Yamaguchi et al., Appl. Phys. A 99, 23 (2010).
- [34] T. Tomita et al., Appl. Phys. A 100, 113 (2010).
- [35] Y. Izawa et al., Jpn. J. Appl. Phys. 45, 5791 (2006).
- [36] M. Deki et al., Appl. Phys. Lett. 98, 133104 (2011).
- [37] L. Jiang and H.L. Tsai, Int'l. J. Heat Mass Transfer 48, 487 (2005).
- [38] S. Kawata et al., Nature 412, 697 (2001).
- [39] A. Marcinkevičius et al., Opt. Lett. 26, 277 (2001).
- [40] T. Okada et al., J. Appl. Phys. 106, 054307 (2009).
- [41] M. Yamamoto et al., Appl. Phys. Express 3, 016603, (2010).

- [42] V.R. Bhardwaj et al., Phys. Rev. Lett. 96, 057404 (2006).
- [43] R. Taylor et al., Laser Photon. Rev. 2, 26 (2008).
- [44] T. Okada et al., Mater. Sci. Forum 725, 19 (2012).
- [45] Y. Hayasaki et al., Opt. Express 19, 5725 (2011).
- [46] Y. Hayasaki et al., Opt. Mater Express 2, 691 (2012).
- [47] S.K. Sundaram and E. Mazur, Nature Mat. 1, 217 (2002).
- [48] S. Juodkazis et al., Phys. Rev. Lett. 96, 166101 (2006)
- [49] K. Sokolowski-Tinten et al., Phys. Rev. Lett. 81, 224 (1998).
- [50]富田卓朗他:レーザー研究 40,592 (2012).
- [51] T. Tomita et al., Opt. Express 20, 29329 (2012).
- [52] D. Perez and L.J. Lewis, Phys. Rev. B 67, 184102 (2003).
- [53] P. Lorazo et al., Phys. Rev. B 73, 134108 (2006).
- [54] L.V. Zhigilei et al., J. Phys. Chem. C 113, 11892 (2009).



富田卓朗

徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研 究部 助教.主な研究分野:光物性,半導 体物理,光物理,特に,光照射によって固 体表面及び内部に生じる不安定状態とその

緩和過程に興味を持っている.趣味は,水泳,釣り,読書.最 近は育児(2歳の双子)に追われ,釣りに行く時間が取れな い.釣りの代わりにスーパーの鮮魚コーナーに立ち寄るのが 趣味になりつつある.

講座 レーザー生成プラズマの新しい温度,密度領域における物性とシミュレーション

5. レーザー加工のシミュレーション

5. Numerical Simulation of Laser Processing

山田知典,山下 晋,杉原健太,村松壽晴

YAMADA Tomonori, YAMASHITA Susumu, SUGIHARA Kenta and MURAMATSU Toshiharu

(独)日本原子力研究開発機構敦賀本部レーザー共同研究所

(原稿受付:2013年5月21日)

レーザー加工プロセスには、時間、空間スケールの異なる多くの物理機構が存在するため、複雑さや計算の 難しさから、十分に解明されているとは言い難い.本章では、こうしたレーザー加工時の複合物理現象の解明に 向けて開発されてきたシミュレーションモデルを紹介する.さらに、筆者らが開発を行った数値シミュレーショ ンコード (SPLICE)を用いたレーザー溶接・切断の数値シミュレーション結果と、放射光高輝度単色 X 線を用い た高精度実験やレーザーによる厚板鋼材切断試験の結果との比較対比を通じて得られた知見・課題等について紹 介する.

Keywords:

laser welding, laser cutting, one-fluid model, multiphase flow, phase change

5.1 はじめに

原子力発電所をはじめとした原子力施設,放射線取扱施 設等では,作業者の被ばく低減などの観点から,遠隔操作 により安全に作業することが望まれている.レーザーは, 出力密度制御や局所加工性,遠隔操作性に優れるため,一 般産業分野において今後最も期待される技術の一つである が,原子力分野での活用はそれにも増して期待される.本 章ではその中でとりわけ重要なレーザー加工に絞って主と して筆者らの研究開発を紹介する.レーザー加工プロセス には,時間,空間スケールの異なる多くの物理機構が存在 するため,複雑さや計測の難しさから,既往研究だけでは, 十分に解明されているとは言い難い.こうしたレーザー加 工時の複合物理現象の解明に向けた取り組みとして,数値 シミュレーションと,それに連携した高精度実験による レーザー加工技術高度化に向けた取り組みの一端を紹介す る.

5.2 レーザー加工プロセスにおける複雑な物理 現象とその数値シミュレーション

レーザー加工時の溶融・凝固現象のリアルタイム観測の ためX線透過法を用いた材料内部の観察が行われ,内部の 大きな流れ場や,気泡,Keyhole などの可視化には成功し ている[1,2].しかしながら,X線管では単位スペクトル幅 あたりの強度が弱いこともあり,固液(固体と液体の)界 面など密度差の小さい界面の像は明瞭に撮影することはで きない.更に,一般に溶融池内部の詳細な温度分布等の物 理量計測が困難であるため,実験だけで現象を把握するこ とは非常に難しく,測定値との比較対比により実験との対 応可能な数値シミュレーションと合わせた評価が重要となる.次にその一例として,固液界面を扱ったシミュレー ションの例を紹介する.

図1に示すようにレーザーにより溶融が起こり,熱伝導 で溶融領域が周囲に膨張する.溶融池の中では対流が起こ り,それが溶融池の膨張等にも影響を及ぼす.固液界面と はこの溶融池の境界のことで,レーザー加工の基礎的パラ メータとして重要であり、シミュレーションにおいても、 その解法がキーポイントとなる.図1に示す溶融池表面は 平らではないが,Wangら[3]は,溶融池表面を平面と仮定 してシミュレーションを行い,対流の渦は界面近傍で生 じ,それが熱伝導や球状の溶融池形成を促すことを明らか にした.しかし,溶融池界面挙動は内部流動場に対し大き な影響を与えると考えられるため、フラットな溶融池界面 は内部流動場の詳細を明らかにするには不十分である.こ れに対し,溶融池界面の変動を考慮した研究もある.Ha



図1 高速度カメラによるレーザー溶接中の溶融池(Molten metal)とビード(Weld bead)形成挙動の撮影結果.

Applied Laser Technology Institute Tsuruga Head Office, Japan Atomic Energy Agency, Tsuruga, FUKUI 914-8585, Japan

Corresopounding author's e-mail: yamada.tomonori41@jaea.go.jp

ら[4]は、界面追跡手法に VOF (Volume of Fluid) 法[5]を 用い、溶融池界面の幅と深さが、界面変動を考慮しない場 合の結果と比較し、界面変動を考慮した場合は溶融時の界 面振動によりわずかに広く深くなることを明らかにした. ここで VOF 法とは、計算セル内での気相と液相の体積比 率により相界面を捕獲する方法であり、これにより各相で の密度や粘性係数などの物性値を定義することができる.

深溶込み溶接の複雑な現象のシミュレーションも行われ ている.Kiら[6,7]は,Level-Set法[8]を用い,溶融池界面 変動,蒸発反跳力,レーザーの多重反射を考慮したKeyhole 生成シミュレーションモデルを開発し,近似のない界 面変動及び Keyhole 挙動の再現に成功した.ここで Keyhole とは,図2に示すようにレーザーを移動しながら深溶 け込み溶接をする際,照射レーザー強度を上げると (10⁶ W/cm² 以上[9]),レーザー照射部にプラズマが発生 し,深く細い穴があいたような状態ができることであり, それを追うように深い溶融池が生じるものである.

野口ら[10]は VOF 法を用いて, Ki らと同様にレーザー の多重反射、材料の蒸発、蒸発反跳力を考慮した熱流体解 析手法を提案し, Keyhole 形成過程における穴壁面の吸収 レーザーパワー分布の変化、溶融金属の流速分布の変化お よび材料の違いによる加工穴形状の違いなどを検討した. これらの研究は、いずれも気液(気体と液体の)界面のみ を対象とした二相流体問題であるため, 溶接母材の溶融・ 凝固やその周囲雰囲気ガスとの相互作用を取り扱うことは できない.また,Level-Set 法を用いた場合には,自由表面 が陰的表現のため, Level-Set 関数の再初期化の過程で非物 理的な体積変動が生じるなど、物理量が保存しないといっ た問題がある. レーザー溶接・切断においては、シールド ガス,アシストガスを用いるため,溶融池界面と周囲雰囲 気ガスとの相互作用を考慮する必要がある.また、溶融・ 凝固過程の再現と、多くのマルチスケール複合現象を内包 するため大規模計算が必須となる.したがって、非常に計 算効率の高い気液固の三相を統一的に扱えるシミュレー ションモデルを構築することが必要となる.

以上の要請を満たすために筆者らの研究では、気液二相 流の数値シミュレーションモデルとして、各相を同一の方 程式系で統一的に解く一流体モデルを採用した.この一流 体モデルに対する離散化として、Xiaoらが提案した有限体



図 2 パワー密度が高い場合に形成される Keyhole 型の深溶込み 溶接の模式図.

積法に基づくマルチモーメント離散化モデルである VSIAM3 [11,12]を用いている.本研究では以下に示す理由により, VSIAM3 を採用した.

- ・他のマルチモーメント数値計算モデルに比べ,計算セル の表面と中心にだけステンシルを配置するため,比較的 計算コストが低い.
- ・有限体積法に基づいているため,質量や運動量などの物 理量が厳密に保存する.
- ・界面追跡スキーム(流体率関数の移流スキーム)に,流 体の保存性と界面形状の精度に定評のあるTHINC/ WLIC法[13,14]を採用した.この手法では界面の拡散が 生じないため,Level-Set法における界面の再構築を必要 とせず,かつ流体率が完全に保存する.ここで流体率と は,計算メッシュ内の各相の流体が占める割合である.
- 気液それぞれの相の境界面が大きく変化するような場合
 に直交座標系を用いて複雑な境界面を表すことができる
 ため界面変形による計算格子の再構成の必要がなく、数
 値誤差や数値不安定性を低減することが可能である.

5.3 主要現象のモデリング

5.3.1 支配方程式

レーザー照射により形成される溶融池は流体として取り 扱うことができるため、非圧縮粘性流体を仮定する.支配 方程式は、連続の式、Navier-Stokes 方程式、エネルギー方 程式で記述される.

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0, \tag{1}$$

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + \frac{\partial u_i u_j}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial_{\rho}}{\partial x_i} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial x_j} (2\mu D_{ij}) + g_i + F_i, \quad (2)$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} + u_i \frac{\partial T}{\partial x_i} = \frac{1}{\rho C_v} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x_i} \right) + \frac{Q}{\rho C_v}, \quad (3)$$

ここで、重複する添え字は特に断らない限り総和規約をと ることとし、 u_i , T, ρ , p, μ , C_v , λ , Q, D_{ij} , $g_i = (0, 0, -g)$, F_i はそれぞれ、速度ベクトル、温度、密度、圧力、粘性係 数、比熱、熱伝導率、熱源、速度歪テンソル、重力加速度、 外力項である.

また,固相・気相・液相といった多相流体を表現するため,VOF法により各種流体を識別している.VOF 関数 ϕ の支配方程式は次式となる.

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{\partial (u_i \phi)}{\partial x_i} - \frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0, \qquad (4)$$

式(4)により、 ϕ ($0 \le \phi \le 1$, 1:流体内部, 0:それ以外 の領域)を用いて各計算セルにおける物性値Y(密度, 粘性 係数, 比熱等) は次のように表される.

$$Y(\phi) = Y_S \phi_S + Y_L \phi_L + Y_G (1 - \phi_S - \phi_L), \qquad (5)$$

ここで, 添え字*S*, *L*, *G* はそれぞれ固相, 液相, 気相を表 す.

溶融池界面では、レーザー照射により照射点とその周囲 の温度勾配により、界面の接線方向の応力が駆動力となる

C

Marangoni 対流が生じる (図3). この効果を次式により 考慮した[15,16].

$$F_{i} = \sigma \kappa n_{i} - \frac{\partial \sigma}{\partial T} \left[(I_{ij} - n_{i} n_{j}) \frac{\partial T}{\partial x_{j}} \right], \qquad (6)$$

 n_i は流体界面に垂直な単位法線ベクトル, κ は曲率, σ は表面張力係数, I_{ij} は単位行列であり, n_i , κ はそれぞれ 次のように表される.

$$n_{i} = \frac{\partial \phi / \partial x_{i}}{|\partial / \partial x_{i}|}, \qquad \kappa = -\frac{\partial n_{i}}{\partial x_{i}}, \qquad (7)$$

式(6)右辺第一項は,表面張力の法線方向に関する寄与, 右辺第二項は界面上での表面張力勾配の寄与である (Marangoni stress).

5.3.2 相変化モデル

液相線,固相線の決定には温度回復法[17]を用いる (図4).この手法により相変化量の経時変化が推算でき, この体積変化量を本手法では流体率変化として直接的に取 り扱う.固体から液体への潜熱放出量は次式で定義する.

$$Q_S = \rho \varDelta V \varDelta g L, \qquad (8)$$

ここで, *ΔV* は計算セル体積, *Δg* は固相 (液相) 率の変化, *L* は融解(凝固) 潜熱である.

計算手順

- ① 相変化のない場合の温度分布を求める.
- ② 1単位時間ステップ内での液相線温度 T_L からの温度 降下 ($\Delta T = T_L - T$)を求める.
- ③ $\Delta T > 0$ ならば物質は凝固し、物質の温度は液相線温度 T_L へ回復する.従って、

$$Q_S = \rho C_p \Delta V \Delta T, \qquad (9)$$

④ 最終的に,物質率の変化量 *Δg* が得られる.



$$\Delta g = C_p \, \Delta T / L \,, \tag{10}$$

⑤ 本手法では相変化量 Δg が流体率変化量 Δφ と同等とし、流体率へ加える.

$$\phi = \phi \pm \varDelta \phi \,. \tag{11}$$

5.3.3 固相表現方法

固相に関しては、Hirtらによって提案された FAVOR (Fractional Area Volume Obstacle Representation) 法 [18,19]により表現する.体積占有率および面積開口率を それぞれ A, A_x, A_y, A_z とし, $A = 1 - \phi_S$ とする. これに より固体の外部は1であるから通常の計算が行われ,内部 では0であるから固体として扱われる.

以上より,固相にレーザー等による熱源が加わり融点を 超え相変化が起きる時,温度回復法により液相率が時々 刻々増加し,その分だけ固相率が減少する.毎ステップ $A = 1 - \phi_S$ を定義しなおせば固液界面の時間変化が追跡で きる.ここで,固相率とは,計算メッシュ内の各相の固体 が占める割合である.

5.3.4 レーザー入熱モデル

レーザー照射による物質中への入熱モデルとしては、次 式に示すBouguer-Lambert-Beer法則[20]が知られている.

$$q(x, y, z, t) = (1 - R)q_0(x, y, t)\exp(-\alpha z),$$
(12)

従って,式(3)右辺第二項のQは次式となる.

$$Q = -\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}z} = -(1-R)q_0\alpha\,\exp\left(-\alpha z\right),\tag{13}$$

ここで R, a は波長依存の反射率および吸収係数を表す. また,それらはレーザー照射による入熱,相変化,化学反応により変化する.入射光強度は空間関数 f(x,y) (本研究では母材表面上での入熱プロファイルを表す)および時間関数 g(t) の積: $q_0 = q_m f(x,y)g(t)$ で表される.本研究では,時間関数 g(t) は一定とし,空間関数 f(x,y) は,(14)式で表されるガウス分布を用いた. $R \ge a$ は物質とその相を特定し,温度を限定するとデータとして与えられる定数であるが,実際はレーザーと被照射物質の時々刻々と変化する相互作用により,相が複雑に変化し,それに対応して入熱が決まる複合的な複雑な現象である.そこで,本研究では、5.4節に示す実験結果に合致するように反射率 R,吸収係数 a を人為的に選んでいる.レーザーと被照射物との相互作用の物理的詳細は課題となっている.

$$f(x, y) = \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{r_0^2}\right),$$
(14)

ここで, r_0 および q_m はそれぞれレーザー照射半径,レーザー出力密度 $[W/m^2]$ である.

5.4 溶接・切断のシミュレーションと実験結果

図5に大型放射光施設SPring-8の高輝度単色X線を用いた吸収コントラストイメージング法により観測されたアルミニウム合金中の溶融池内流動場の実験配置を示す.単色

で超高強度であることから溶融池境界がリアルタイムで鮮 明に撮影できるのが特徴である.図6に実験結果を示す. 図中の時間は、レーザー照射開始時をt=0としている.試 験片表面には、トレーサー粒子(炭化タンタル)を散布し、 出力260Wでレーザーを照射した.トレーサー粒子は、溶 融池内対流により中心から斜め下方向に移動した後、再び 中心付近で上昇している様子が確認された.また、レー ザーを照射し続けると、溶融金属内部で気泡が発生した. 気泡は、対流や浮力により溶融池内部を移動したが、凝固 速度が非常に速いため、試験片内部に閉じ込められ、溶接 欠陥となった.

図7に、図6と同等の条件でのSPLICE (residual Stress control using Phenomenological modeling for Laser welding repair process In Computational Environment) コードによ る数値シミュレーション結果を示す. レーザー入熱により 母材が溶融し溶融池が形成された. 矢印は流体の速度の方 向と大きさを示し、等高線表示は温度分布を示す. 図中の 速度分布より、気液界面の中央へのレーザー入熱により母 材が溶融し、溶融池が形成され、Marangoni効果によって、 その加熱された部分から界面の接線方向に沿うように固相 界面への流れが生じていることがわかる.これは、固液界 面での温度差に起因するものであり, 固液界面近傍で最大 となった. また, 溶融池内には, 固液界面に衝突して生じ る強い渦と、溶融池中心で生じる比較的弱い渦の2つの渦 が形成された.図6の対流挙動とは若干異なるが、実験で はトレーサー粒子を母材表面に散布しているため、その溶 融にレーザーのエネルギーが消費され、その残りがアルミ ニウムの溶融に寄与することになっているのも異なった現 象が生じている原因の一つと推測される.多様なパラメー タでの比較対比が望まれる.

このようにして金属の溶融・凝固過程を実験とシミュ レーション結果とを比較対比しつつ計算コードの精度を高 めている.次にこのコードをレーザーによる厚板金属切断 に適用した例を紹介する.レーザー厚板切断とは、レー ザー光と同軸方向に強いガス流を発生させ、そのガス流で レーザー照射により生じた溶融金属を吹き飛ばしながら高 速で切断する手法である.図8にレーザー切断の数値シ ミュレーション結果を示す.温度分布の等高線に、固体金 属表面,溶融金属表面,流体の速度ベクトルを重ねて表示



図5 試験片にレーザー照射した際に形成する溶融池と単色 X 線 による観察.



図6 高輝度単色 X 線を用いた吸収コントラストイメージング法による溶融池内観測[21,22].撮影の時間分解能を考慮し、材料表面で変化が起こった瞬間をレーザー照射開始(t=0)と仮定した.ここでレーザー照射時間は10秒である.(a)~(f)は照射開始から1.43秒,3.08秒,5.29秒,5.35秒,10.41秒,10.53秒後の像である.(e)~(f)は加熱時間10秒後の凝固過程を示しており、レーザー照射中に発生した気泡(Bubbles)が試験片内部に閉じ込められ、溶接欠陥(Weld Defect)となった.







図8 厚板のレーザー切断シミュレーション[25,26]. 最上段が 切断配置図. (A),(B)はそれぞれ順調な切断,切断残り の生じた切断過程を示す. ピアシングホール(Piercing hole)の一端に照射されたレーザーが切断方向(Cutting direction)に移動することにより,溶融が生じ,その溶融 物をガスにより除去しつつ切断は進行する.ここで切断対 象物の物性値として純鉄の溶融金属流体物性データを使 用.

している. レーザー加工ヘッドの移動速度 V。(切断速 度)およびアシストガス Ug 速度は下記のように設定した. ・ケースA: $V_S = 200 [\text{mm/min}], U_g = 10 [\text{m/sec}].$ ・ケースB: $V_S = 300 [\text{mm/min}], U_g = 10 [\text{m/sec}].$ ケース A では、切断速度が遅いため、レーザー入熱は板裏 部分へ直ちに伝熱される.入熱により溶融した金属は、ア シストガスにより直ちに外部に排除され、新たに露出した 固相表面にレーザー入熱されるという過程を経て切断フロ ントが形成された.しかしながら、ケースBのように切断 速度が極端に速くなると, 切断開始点の板裏部分への伝熱 遅れが生じ、融点に達しないため固相のまま残存する.こ の固相は、溶融金属の排出を妨げるため、レーザー照射直 下に溶融金属が留まることになり、板裏への貫通が遅延す る.一度貫通してしまえば、固体金属は残熱の影響で溶け やすくなるため、ほぼ定常的に切断フロントが形成される が、伝熱遅れにより固相のまま残存した金属は切断残りと なる.このような切断残りが生じることは、実際のレー ザー切断試験でも確認されている (図9).

この切断バージョンのシミュレーションコードを用い て、レーザーパワー、切断厚さ、切断スピードの関係を実 験結果のそれらと比較する試みも行っており、切断スピー ドが比較的速い領域での両者の一致が得られている.その 一方で切断スピードの遅い領域でのシミュレーションの課 題も浮かび上がってきている[27].このシミュレーション により、所定の厚さの鋼材等の切断に必要なレーザーパ ワー、切断スピード等が一定の信頼性のもと予測できる可 能性があり、課題を明確にしつつ、着実に開発を進め整備 していく所存である.

5.5 おわりに

数値シミュレーションを利用することにより,実験計測 だけでは困難なレーザー溶接・切断中の金属内部の現象を 再現でき,実験結果との比較・検討により,現象の定量評 価が可能となる.また,近年は高出力ファイバーレーザー



図 9 レーザー切断後の試験片表面(レーザー照射面)および裏面[25,26].切断速度が速いため、裏面に切断残り(Failure in cutting と矢印で示した部分)が生じた.

の開発により、それらを導入した厚板の溶接・切断などの 試験が活発に行われているが[28],数値シミュレーション の利用は、目的とする厚みに対し必要となる出力の選定に 役立つとともに、溶接・切断の可否を決定する一つの指標 となる.現状では、実験とシミュレーションにより典型的 な現象に対して定性的な解釈が可能になったことが成果と して確認できる.今後物理モデルの高度化、関連する物性 値のデータベース化を進めることにより、汎用性の高い、 実際のレーザー加工に対しても役立つシミュレーション コードの開発をめざしたい.

参考文献

- [1] 木下圭介 他:溶接学会論文集 25,18 (2007).
- [2] Y. Arata et al., Trans. JWRI 14-2, 17 (1985).
- [3] H. Wang et al., J. Phys. D: Appl. Phys 39, 4722 (2006).
- [4] E.J. Ha and W.S. Kim, Int. J. Heat and Fluid Flow **26**, 613 (2005).
- [5] D.B. Kothe *et al.*, AIAA paper **96**, 0859 (1996).
- [6] H. Ki et al., Metall. Mater. Trans. A 33A, 1817 (2002).
- [7] H. Ki et al., Metall. Mater. Trans. A 33A, 1831 (2002).
- [8] M. Sussman, J. Comp. Phys. 114, 146 (1994).
- [9] S. Fufinaga et al., J. Phys. D, 33, 492 (2000)
- [10] 野口 暁 他:レーザ加工学会誌 14,113 (2007).
- [11] F. Xiao, J. Comp. Phys. 195, 629 (2004).
- [12] F. Xiao, J. Comp. Phys. 213, 31(2006).
- [13] F. Xiao, Int. J. Numer. Meth. Fluids 48, 1023 (2005).
- [14] K. Yokoi, J. Comp. Phys. 226, 1985 (2007).
- [15] M. Lappa, CMC 2, 51 (2005).
- [16] H. Haj-Hariri and Q. Shi, Phys. Fluids 9, 845 (1997).
- [17] 大中逸雄:コンピュータ伝熱・凝固解析入門鋳造プロ セスへの応用(丸善株式会社).
- [18] C.W. Hirt, J. Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 46-47, 327 (1993).
- [19] 森川泰成:日本建築学会学術講演梗概集D環境工学, 497 (1992).
- [20] E.N. Sobol, Phase Transformations and Ablation in Laser-Treated Solids (A Wiley-interscience publication, Hoboken, New Jersey, 1995).
- [21] T. Yamada et al., Proc. Visual-JW2012, JWP-33, 67 (2012).
- [22] T. Yamada et al., JLMN, 7, 244 (2012).
- [23] S. Yamashita et al., Q. J. Jpn. Weld. Soc., 29, 48s (2011).
- [24] 山下 晋他:第25回数値流体力学シンポジウム, C08-2, (2011).
- [25] K. Sugihara et al., Proc. 20th Int. Conf. Nucl. Eng., ICONE 20-54185, (2012).
- [26] 杉原健太 他:第25回数値流体力学シンポジウム, C08-1, (2012).
- [27] 杉原健太他:原子力学会2013年春の年会講演予稿集, A01,1 (2013).
- [28] 例えば,大道博行他:第77回レーザ加工学会講演論文 集,9(2012).



やま だ とも のり

2010年3月大阪大学大学院 工学研究科 マ テリアル生産科学専攻 博士後期課程修了 (博士(工学)). 2010年4月より日本原子 力研究開発機構敦賀本部レーザー共同研究

所,博士研究員. 2013年4月より日本原子力研究開発機構敦 賀本部レーザー共同研究所,任期付研究員.現在に至る.主 な研究分野は材料工学.



が原健太

2011年3月東京工業大学大学院理工学研究 科原子核工学専攻博士課程修了,博士(工 学). 2011年4月より日本原子力研究開発 機構敦賀本部レーザー共同研究所,博士研

究員. 2013年5月より現在, ライス大学研究員. 主な研究分 野:数值流体力学, HPC, GPU 計算, 気液二相流, 流体構造 練成解析.



やま した すすむ 一型

日本原子力研究開発機構原子力基礎工学研 究部門熱流動研究グループ研究員.東京工 業大学大学院総合理工学研究科博士後期課 程修了(博士(工学)).専門は数値流体力 学.現在はシビアアクシデント時における炉内状況の数値流

体力学的研究に従事.



6. 磁場閉じ込め核融合におけるペレット溶発の物理と応用

6. Elementary Press and Applications of Pellet Ablation in Magnetically Confined High Temperature Plasma

坂本隆一,後藤基志 SAKAMOTO Ryuichi and GOTO Motoshi 核融合科学研究所 (原稿受付: 2013年6月21日)

磁場閉じ込め核融合炉における燃料供給手段として考えられている固体水素ペレット入射法の粒子供給特 性を支配する二つの素過程,すなわち『固体水素の溶発過程』と『溶発プラズモイドの均質化過程』について紹 介する.高温プラズマ中で溶発する固体水素ペレットは,電子やイオンといった粒子が運ぶ熱流束によって溶発 され,溶発後形成される高密度プラズモイドは閉じ込め磁場の影響を受けながら背景プラズマへ均質化していく ことから,レーザー照射によるプラズマ生成過程とは大きく異なる側面を持つ.固体水素ペレット入射による粒 子供給素過程の物理について解説するとともに,溶発過程の観測手法(プラズマの分光計測)や固体水素ペレッ トの入射技術も紹介する.

Keywords:

fusion reactor, fueling, solid hydrogen pellet injection, ablation

6.1 磁場閉じ込め核融合装置における粒子供給

磁場閉じ込め核融合炉では、電荷を帯びた核融合生成 物, すなわち, アルファ粒子 (ヘリウム) がもつエネルギー でプラズマを加熱する状態(自己燃焼状態)の定常維持を 行い,外部からのプラズマ加熱は必要なくなる(もしくは, かなり小さな割合となる).一方で、燃料となる水素同位 体(重水素および三重水素)は、核融合反応に伴ってヘリ ウムと中性子に変換されていくため、燃焼領域 (コア部) への継続的な水素同位体の供給が燃焼プラズマを維持する ための重要な制御手段となっている. また, 核融合反応生 成物であるヘリウムがプラズマ中に蓄積すると、燃料希釈 によって核融合反応率を低下させ、燃焼プラズマの維持に 支障を来すために、燃料供給に加えてヘリウムの速やかな 除去も重要な課題である.しかしながら,既存のプラズマ 装置における『燃焼を伴わない』高温プラズマ実験では, 燃料減少とヘリウム除去の問題が生じないことに加えて, プラズマサイズが小さく,密度も低いために,中性粒子 (ガスパフやリサイクリング)による粒子供給が有効に働 くことから、粒子供給やヘリウム除去に関わる課題が燃焼 プラズマにおいて本質的に重要であるにもかかわらず,未 だその重要性は十分に認識されていない.

核融合炉における燃焼率(供給粒子数に対する核融合反応する粒子数の割合)は数%程度[1,2]と想定されており, 燃焼する粒子数の数10倍から100倍程度の粒子数(~10²³ atoms)を供給する必要がある.そもそも,粒子の供給はプ ラズマ外部から行う必要があるが,プラズマ密度が低い周 辺部から、より密度が高いコア部へ燃料を供給しなければ ならないため、拡散的描像ではコア部へ粒子を供給するこ とができない. この核融合炉における粒子供給の問題を解 決するためには,内向きの対流などによる粒子輸送の補償 が必要となる. その一方で, 内向きの対流はヘリウム除去 と相反するばかりでなく、 プラズマ壁相互作用によってプ ラズマ周辺部で発生する不純物のプラズマコア部への蓄積 などを引き起こす.この相反する要求を緩和させるために は、コア部への直接粒子供給が最も有効である。 高温プラ ズマへの直接粒子供給法の候補として、中性粒子ビーム入 射(NBI)や固体水素ペレット入射を用いた粒子供給が挙 げられる.NBIは加熱装置であると同時に、コア部へ粒子 を供給できるために高温プラズマへの粒子供給法としては 非常に有効であり、これまでの高温プラズマ実験の進展に 大きく寄与してきた. しかしながら, 核融合炉への粒子供 給を想定すると核融合出力よりも大きな入射電力が必要と なるため、炉では粒子供給手段として使用することはでき ない. 固体水素ペレット入射法は、1 km/s 程度に加速した 固体水素の粒をプラズマ中へ入射させる粒子供給法であ り、高温プラズマに曝されて溶発しながら飛翔して粒子を プラズマへ供給する. 現時点では、ペレット入射法は核融 合炉への粒子供給を想定できる唯一の粒子供給法と考えら れている. 核融合炉における粒子供給特性を理解するため には, 高温プラズマに曝される固体水素の溶発素過程の理 解が重要であり、1970年代から理論・実験の両面から研究 が続けられてきている[3,4].本章では、固体水素ペレット

National Institute for Fusion Science Toki, GIFU 509-5292, Japan

Corresopounding author's e-mail: sakamoto@LHD.nifs.ac.jp

Lecture Note

入射による粒子供給の素過程について解説する.

6.2 固体水素ペレットによる高温プラズマへの 粒子供給素過程

固体水素ペレット入射による粒子供給は『固体水素の溶 発過程』と『溶発プラズモイドの均質化過程』の二つの素 過程により記述される.ペレット粒子供給研究の初期にお いては,固体水素の溶発過程を明らかにすることによっ て,粒子供給特性の理解が試みられてきた.しかしながら, ペレットの溶発位置と実効的な粒子供給分布が必ずしも一 致しない実験結果が示され,粒子供給特性を理解するため には,固体水素ペレットが何処で溶発したかだけではな く,溶発した粒子によってペレット周囲に形成される高密 度のプラズマ塊(プラズモイド)が背景プラズマへ均質化 していく過程も考慮することが重要であることが明らかと なった.ここでは,高温プラズマへの固体水素ペレット粒 子供給特性を記述する二つの素過程を説明する理論モデル の概要とその実験的検証を紹介する.

6.2.1 ペレット溶発

高温プラズマ中に入射された固体水素ペレットはプラズ マからの入熱を受けて溶発するが、プラズマからの入熱量 と固体水素の昇華エネルギーから推定される寿命(マイク ロ秒)よりもはるかに長い寿命(ミリ秒)を持つ.そのた め、高温プラズマ中に高速で入射されたペレットは、溶発 しながらプラズマ中へ深く(数10 cm から1 m)侵入し、コ アプラズマへ粒子を供給することが可能である.固体水素 ペレットが高温プラズマ中でも比較的長い寿命を持つこと は、ペレットが溶発してペレット周囲に拡がる溶発雲(中 性ガス)が、プラズマからの熱流束を遮蔽していると考え ることによって、説明することが可能である.溶発雲に よってプラズマからの熱流束が遮蔽され、固体水素ペレッ トの溶発が抑制される点は、エネルギーを担うものが粒子 (電子やイオン)であることに起因している.

ペレット溶発を記述するモデルは、1970年代後半に P.B. Parks[5]らやS.L. Mirola[6]らによって構築され、中性ガス 雲遮蔽モデル (Neutral Gas Shielding; NGS モデル) と呼ば れている. 簡略化を大胆に行っているにも関わらず, 様々 な装置におけるペレット入射実験の結果を大まかに説明で きることから、その後、様々な現実的な影響を考慮した詳 細なモデルが提唱されたにも関わらず、最も広く受け入れ られている. P.B. ParksらのモデルとS.L. Mirolaらのモデル は解法に差異があるものの、取り扱っている溶発物理の描 像はほとんど同様である. すなわち, プラズマからの熱流 束を受けてペレットが溶発し、ペレットの周囲に中性の溶 発雲が等方的に広がる.プラズマからの熱流束は溶発雲で 遮蔽され、大部分の入熱は溶発雲を加熱することに費やさ れるため、固体水素ペレット表面に到達する熱流速の割合 は無視できるほど小さく、溶発現象は熱流束の遮蔽に最低 限必要な粒子量が固体水素ペレットの溶発率になるように 自己調整されている. このことを利用して NGS モデルで は、プラズマからの熱流束を遮蔽するために必要な溶発雲 を形成するために必要な粒子量として溶発率を求めてお

り,固体から気体への相変化に伴う複雑な現象を直接考慮 することなく溶発率を求めている.

入射粒子の質量,温度,密度を*m*,*T*,*n*とすると,プラ ズマからのエネルギー束は $n\sqrt{T^3/m}$ に比例するので、イオ ンと電子の温度が等しい水素プラズマを想定すると、イオ ンと電子が担うエネルギー束の比は $q_e/q_i \sim \sqrt{m_i/m_e} \sim 42$ となり、ペレットに流入するエネルギー束は電子が支配的 である.ただし,添字の e と i はイオンと電子を表す. さら に、中性ガス中におけるイオンの損失関数は電子のそれに 比べると大きいため、イオンのエネルギーは中性ガス中で は電子に比べて急激に減衰し、ペレット表面まで到達でき ない.したがって、電子の熱流束のみが溶発に寄与すると 仮定している(図1). さらに簡単のため、マックスウェル 分布している熱化プラズマの電子のエネルギー分布を, $E_{\rm e} = 2T_{\rm e}$ の単色エネルギーで近似している.溶発した水素 原子は溶発雲(中性ガス)としてペレット周囲に広がるが, 中性ガスであることから磁場の影響を受けず、ペレットを 中心とした同心球状に広がると仮定し、現象は半径方向の 1次元の関数で記述している.また、ペレットの移動に伴 う背景プラズマの変化の時間スケール (>10⁻⁶ s) に比べ て溶発雲が形成される時間スケール(~10⁻⁷s)は十分に 速いことから,溶発現象は準定常近似が成り立っている. このような仮定のもと,溶発雲の動態は質量保存,運動量 保存、エネルギー保存の式および理想気体の状態方程式は 次式で表される.

$$\rho v r^2 = \frac{G}{4\pi},\tag{1}$$

$$pv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r} + \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} = 0, \qquad (2)$$

$$\rho v \frac{d}{dr} \left(\frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{kT}{m} + \frac{v^2}{2} \right) = Q \frac{\mathrm{d}q_{\mathrm{e}}}{\mathrm{d}r}, \qquad (3)$$

$$p = \frac{\rho}{m} kT. \tag{4}$$



図1 固体水素ペレットの周囲に球状(等方的)に広がる中性溶 発雲内の中性ガス密度分布とイオン・電子熱流束分布.rp とriはそれぞれ、ペレット半径と、中性溶発雲のイオン化 半径を示す.プラズマから流入するイオン熱流束は中性遮 蔽雲で遮蔽され、固体水素表面まで到達しないため、中性 ガス遮蔽モデルでは、電子の熱流速による固体水素の溶発 のみを考慮している.

ここで, m は溶発粒子の平均質量, v は溶発雲の流速, pは溶発雲の圧力, T は溶発雲の温度, r は比熱比, G は溶発 率, Q は電子のエネルギー損失 (dq_e/dr) が溶発雲の加熱 に用いられる割合である.溶発雲への入射電子は, 電離や 励起といった非弾性過程によってエネルギーを失うと同時 に弾性散乱を受け, 溶発雲を膨張させる加熱源となる.こ のとき,電子のエネルギー損失関数をL(E),後方散乱と小 角散乱を考慮した実効後方散乱断面積を $\hat{\sigma}_{T}(E)$ とする と,入射電子の溶発雲中でのエネルギー減衰は次式で表さ れる.

$$\frac{\mathrm{d}q_{\mathrm{e}}}{\mathrm{d}r} = \frac{\rho}{m} q_{\mathrm{e}} \left(\hat{\sigma}_{\mathrm{T}}(E) + 2\frac{L(E)}{E} \right), \tag{5}$$

上記の方程式(1) – (5)が溶発雲の動態を表す方程式系と なる. P.B. Parksらは、固体水素の昇華エネルギーはプラズ マからの熱流束に比べて十分小さいことから、固体水素表 面における熱流束と温度が $q_e(r_p) = 0$, $T(r_p) = 0$ になる境 界条件の下で上式を解き、固体水素ペレット半径の縮小速 度が下式でスケールできることを示した.

$$\frac{\mathrm{d}r_{\rm p}}{\mathrm{d}t} = 6.64 \times 10^{-4} T_{\rm e}^{1.64} n_{\rm e}^{\frac{1}{3}} r_{\rm p}^{-\frac{2}{3}},\tag{6}$$

ここで、 T_{e} [keV]、 n_{e} [m⁻³]はプラズマの温度、密度. r_{p} [mm]は球状ペレットの半径である.このモデルは大胆 な簡単化を行っているにもかかわらず、多くの装置におけ る実験結果を大まかに説明できることが知られている[7,8].

現実的な条件を考慮したモデルを構築する多くの試みが なされてきた(詳細はレヴュー論文[4]を参照).例えば、 (1)電子の熱流束にマクスウェル分布を考慮, (2)磁場に 沿って入射する電子の熱流束を考慮,(3)溶発雲の電離に 伴う高密度プラズモイドの形成とそれが磁力線に沿って広 がることを考慮.などの多くのモデルが提唱されてきた. モデルで考慮している仮定によって、推定される溶発雲 (モデルによっては、溶発雲が電離して生じる溶発プラズ モイドも考慮している)の特性は大きく異なるにもかかわ らず固体水素の溶発率はモデルにあまり依存せず、大胆に 簡単化した初期のNGSモデルと同程度であり、必ずしもよ り詳細な物理モデルを考慮することによって、実験結果を 再現できるとはいえない. このことは, 固体水素の昇華エ ネルギーが小さいために、電子の熱流束の遮蔽に必要な溶 発雲が常に維持されるように自己調整されていることに起 因している.

一方で、極端な条件下、例えば、加熱(中性粒子ビーム 加熱や波動加熱)に起因する高エネルギー粒子が存在する 場合は、溶発雲による高エネルギー粒子の遮蔽が十分でな く、固体水素ペレットの溶発がNGSモデルによる予測より も促進される結果が得られており[9-12]、高エネルギー粒 子による溶発を考慮した溶発モデルが提案され[10,13,14], その妥当性が実験結果によって検証されている.

6.2.2 ペレット溶発プラズモイドの均質化過程

ペレットが溶発してペレット周囲に形成される中性の溶 発雲は、プラズマからの熱流束によってさらに加熱され、

高密度の溶発プラズモイドを形成する. 溶発プラズモイド は電離しているため磁力線に沿って広がり,背景プラズマ へと均質化することによって粒子供給を行う.したがっ て、ペレットが溶発した磁気面上にペレット粒子が蓄積 し、ペレット入射前後の密度分布の差から求められる実効 的なペレット粒子供給分布はペレット溶発分布と一致する ことが期待される.しかしながら,高加熱入力した高温プ ラズマでは、溶発発光計測によるペレット溶発位置は NGS モデルによる予測で説明できるにも関わらず、実効粒子供 給分布が浅くなり, 粒子供給効率が低下することが実験的 に明らかになっている[11,15,16]. この現象は、ペレット が溶発して形成される高密度の溶発プラズモイドが即座に 低磁場側 (大半径外向き) ヘドリフトし, ペレット溶発位 置から粒子が吐き出されているという作業仮説の下, ASDEX-Uupgrade において高磁場側(トーラス内側)から ペレットを入射する実験が行われ、溶発プラズモイドが大 半径外側に移動することによって、コア部へ粒子が供給さ れることが示された[17]. その後,多くのトカマク装置に おいて、高磁場側からのペレット入射実験が行われ、溶発 プラズモイドの低磁場側(大半径外向き)へのドリフト輸 送が検証されている[18-22] (詳細はレヴュー論文[4]を参 照). このような溶発プラズモイドのドリフト挙動を説明 する物理機構として、∇B ドリフトモデル(図2)が最も受 け入れられている[23]. 溶発プラズモイドの圧力を bo, 背 景プラズマの圧力を p∞ とすると、トーラス効果による ∇B ドリフトによって, 溶発プラズモイド内で電子とイオ ンは上下反対方向に動き(荷電分離),垂直電流 $j_{\nabla B} = 2(p_{\infty} - p_0)/RB$ が生じる. 開回路条件下では電流 $j_{\nabla B}$ はイオン分極電流 $j_{\text{pol}} = (n_0 m_i / B^2) dE / dt$ によってキャ ンセルされる. 但し, m_i はイオン質量, Eは $j_{\nabla B}$ によって 生じる電場.このため、溶発プラズモイドはドリフト速度 $dv_d/dt = (dE/dt \times B)/B^2 = 2(p_\infty - p_0)/Rn_0m_i$ で加速され る.このモデルでは、溶発プラズモイドが磁力線に沿って トーラス方向に広がると同時に低磁場側にドリフトするこ



図2 トーラスプラズマ中に形成された溶発プラズモイドのドリ フト輸送機構の模式図.

Lecture Note

とによって背景プラズマに均質化していき, $p_{\infty} = p_0$ になるまで加速を受けることになるが,より正確にプラズモイドの均質化過程を記述するためには,プラズモイド加速の減衰を考慮する必要がある.プラズモイドがトーラス方向に広がると,閉じ込め磁場の回転変換によってプラズモイド内の電場と荷電分離の方向が変化し,プラズモイド内には荷電分離を補償する電流が流れ,電場を小さくすることに寄与し,プラズモイドの減衰に寄与する[24,25].さらに、荷電分離した溶発プラズモイドの正と負に帯電した部分に接続する磁力線がオーバーラップすることによって、プラズモイド外の磁力線に沿って流れる抵抗性電流による荷電分離の補償の重要性も指摘されている[26-28].外部電流を考慮すると、垂直電流 j_{VB} は分極電流 j_p と外部電流 $j_{\text{ext.}} = \sigma E$ の和でキャンセルされるので、溶発プラズモイドのドリフト速度 v_{d} は

$$\frac{\mathrm{d}v_{\rm d}}{\mathrm{d}t} = A \, \frac{2 \left(n_0 T_0 - n_\infty T_\infty \right)}{R n_0 m_0} - \frac{\sigma B^2}{m_0 n_0} v_{\rm d} \tag{7}$$

で表される.ここで,右辺第1項(プラズモイドの加速項) 乗じてあるA < 1は内部電流による減衰,右辺第2項 $\sigma B^2 v_{d}/(m_0 n_0)$ は外部電流による減衰を表す.この外部電 流は,磁力線の接続長が短くなる低次の有利面において大 きなプラズモイドの減衰を引き起こす原因となり,実験に よってもモデルの妥当性が検証されている[28,29].なお, トカマク装置では外部電流によるプラズモイド減衰が支配 的であるが,ヘリカル装置では磁場構造の3次元性に起因 して内部電流の影響が相対的に支配的になることが示され ている[30].

6.3 ペレット粒子供給素過程の分光診断

水素ペレット溶発雲は非常に強い光を放出する.この光 の強度,特にバルマーα線強度が水素原子の電離レートに 比例するとみなし,その時間変化からプラズマへの粒子供 給空間分布を見積もるという解析が従来行われてきた.し かしながら,電離レートが発光線強度にほぼ比例するとみ なすことができるのは,プラズマが比較的密度の低い電離 進行プラズマであるという条件を満たす場合であり [31,32],それを確認するためには溶発雲内にどのような プラズマが生成しているのかを知る必要がある.

そのような目的には分光計測が有用である. 溶発雲から の発光を分光計測して得られたスペクトルを図3に示す [33]. このスペクトルが示す注目すべき特徴は,顕著な線 スペクトルの広がりと,強い連続光である. 前者は明らか に,高密度に起因するシュタルク広がりである. バルマー α 線とバルマー β 線の広がりからそれぞれ電子密度を見積 もると,バルマー α 線から求めた値の方が2倍程度大きい. 発光線に自己吸収の影響がある場合,吸収係数はプロファ イル中心の方が大きいため,見た目の広がりが大きくな る. バルマー α 線はバルマー β 線よりも自己吸収の影響が 大きいため,観測される広がりが真の広がりよりも大きく なっていることが後の解析により明らかとなった. 自己吸 収の影響が少ないバルマー β 線のシュタルク広がりの大き



図3 観測されたスペクトルの例と完全局所熱平衡の下での フィッティングの結果.線プロファイルには文献[34]の シュタルク広がりが与えられている.連続光成分 P^A, P^R および P^B はそれぞれ,輻射付着,輻射再結合に伴う成分お よび制動放射成分を示す.[33]より引用.

さから電子密度の値として 2.1×10²³ m⁻³ が得られた.

連続光については,輻射再結合に伴う発光や制動放射光 では観測されるプロファイル(波長依存性)を再現できな い.ここでは,水素原子に自由電子が付着し負イオンを生 成する際に余剰エネルギーを光として放出する過程,輻射 付着過程に伴うものが主な連続光の成分であることが見い だされた.輻射付着過程は光の吸収により負イオンから電 子が剥がされる過程,つまり,光脱離過程の逆過程であり, 光脱離断面積[35]から求められるそのスペクトルは電子温 度に敏感である.溶発雲の観測で得られたスペクトルは電 子温度1eV 程度でよく再現されることが明らかとなった.

以上の解析により電子密度と電子温度が求められた.電子密度が高いため,励起準位は局所熱平衡にあると予想される.その場合,励起準位 p の占有密度 n(p) は次のサハ・ボルツマンの式[32]で表されるはずである.

$$n(p) = p^2 \left(\frac{h^2}{2\pi m_e k T_e}\right)^{3/2} \exp\left(\frac{R}{p^2 k T_e}\right) n_e n_i. \tag{8}$$

ここで, h, k および R はそれぞれ, プランク定数, ボルツ マン定数およびリュードベリ定数である.この式において イオン密度,つまり陽子密度が未知であるが,今対象とし ているプラズマは純粋な水素のプラズマであるとして差し 支えないであろうから,イオン密度は電子密度と等しいと おくことができる.その場合,式(8)からp = 4準位の密度 を求め,バルマー β 線の自然放出係数(アインシュタイン のA係数)および光子のエネルギーを乗ずれば,単位体積 あたりの発光強度が求められる.この結果と計測値との比 からプラズマの体積(1.6×10^{-5} m³)が得られた.

一方,輻射付着過程に伴う連続光放射パワー ρ^{A} は光の振動数 ν の関数として次のように表される.

$$\rho^{A}(\nu) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{h^{4}}{m_{e}^{3/2} c^{2}} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{kT_{e}}\right)^{3/2} \times \exp\left(-\frac{h\nu - \chi_{H^{-}}}{kT_{e}}\right) \sigma_{det}(\nu) \nu^{3} n_{H} n_{e}. \quad (9)$$

ここで、 χ_{H^-} は負イオンの電子脱離エネルギー、 $\sigma_{det}(\nu)$ は負イオンの光脱離断面積、 n_H は原子密度である。単位波 長あたりの放射パワー $P^A(\lambda)$ は次のように変換される。

$$P^{\mathbf{A}}(\lambda) = \rho^{\mathbf{A}}(\nu) \frac{\nu^2}{c}.$$
(10)

上で求めたプラズマ体積を乗ずれば観測される強度に等し くなるはずであり,計測値との比較により式(9)内で未知 であった原子密度の値として1.7×10²⁵m⁻³が求められ た.サハ・ボルツマンの式を基底状態まで適用するとイオ ン密度と原子密度との比が得られる.これを上記の解析結 果と比較するとよく一致する.このことは基底状態も含め た局所熱平衡,いわゆる完全局所熱平衡が成立しているこ とを意味する.先に,プラズマ中で負イオンが生成されて いることが示された.負イオン状態も原子との間に局所熱 平衡が成立しているとすると,負イオン密度はイオン密度 の1%程度であり,プラズマ全体の電荷バランスに影響を 与えるほどではないことが確認できる.

以上の解析により、電子密度(イオン密度)、電子温度, 原子密度およびプラズマ体積が求められ、プラズマが完全 局所熱平衡にあることも示された.その上でもう一度発光 線強度と電離レートとの関係について考えてみる.上で述 べたように発光線強度が電離レートにほぼ比例するのは電 離進行プラズマの場合であり、実際のプラズマは電離と再 結合がバランスする電離平衡プラズマであるため、そのよ うな比例関係は仮定できない.実際には、電離と再結合が ほぼバランスすることで上で求めた性質のプラズマが定常 的に存在しているがほんのわずかに電離の方が優勢で、そ れは拡散等により背景プラズマ中へ流れ出す粒子を補って いると考えられる.今の計測では電離と再結合との差を検 出できるほどの精度はないため、実際単位時間にどの程度 の量の粒子がプラズマに供給されているのかを求めること は困難である.

当初の電離レートを精度よく求めるという目標は達成さ れていないが,溶発雲内で活発に原子過程が生じている領 域のプラズマについて詳しい情報が得られた.とくに,完 全局所熱平衡が成立しているという事実は,シミュレー ションを行う上で原子過程についての取り扱いを簡略化す ることに大きく貢献するため重要である.また,溶発雲内 部の空間構造を知るために進行中であるイメージ計測[36] においてもその威力を発揮している.

6.4 ペレット入射技術

ここでは、固体水素ペレットをどのように生成し、プラ ズマ中に入射するのか簡単に説明する.コア粒子供給を実 現するためには、ペレットのプラズマへの侵入長が十分に 深い必要がある.固体水素のプラズマへの侵入長 λ(m)は、 プラズマの小半径,温度,密度,ペレットの粒子数, 入射速度をそれぞれa(m), $T_e(keV)$, $n_e(10^{20} m^{-3})$, $m_p(10^{20} atoms)$, $v_p(m/s)$ とすると,

$$\lambda/a = 0.079 T_{\rm e}^{-5/9} n_{\rm e}^{-1/9} m_{\rm p}^{5/27} v_{\rm p}^{1/3},\tag{11}$$

でスケールされる[8].ペレット侵入長を決める4つのパ ラメータのうち,ペレット入射条件として最適化可能なパ ラメータはペレット粒子数(サイズ)と入射速度であるが, ペレット粒子数はプラズマ密度の上昇に直接影響を及ぼ し,ターゲットプラズマの条件から受動的に決きまるパラ メータであることを考慮すると,ペレット入射速度のみが ペレット粒子供給特性を最適化するパラメータとなる.ま た,核融合炉での粒子供給を想定すると定常運転が重要で あり,数Hz程度の繰り返し数で定常的に固体水素ペレッ トを入射し続けることが必要となる.

これまで、様々な方式のペレット入射装置が開発されて 来たが[37],最もコンベンショナルなペレット入射法は 『その場生成ニューマチックパイプガン方式』である [38]. このペレット入射法は、バレル (ステンレス鋼製パ イプ)の一部を固体水素三重点温度以下に冷却しておき, そこへ水素ガスを流すことによって、固体水素ペレットを 生成する. その後, 加速ガス(高圧の水素もしくはヘリウ ムガス)を印加することによって、膨張するガスの流れに よってペレットを加速する.ペレットサイズはパイプの内 径と冷却幅で固定され,冷凍部には可動部がないために, 安定かつ信頼性の高いペレット入射が可能である. その一 方で、ペレット射出後に次のペレットを生成するためには 数10秒~1分程度の時間がかかるために、数Hzで連続入 射を行うためには多くのバレルを並列に設置する必要があ る[39]. また、ペレットの入射速度は加速ガスの音速に比 例した値 (= $2\sqrt{\gamma kT/m}/(\gamma-1)$) で制限されるために, 到達 可能なペレット入射速度は最大で<1.5 km/s, 典型的には 1.0 km/s 程度である.

核融合炉における定常ペレット粒子供給を可能とする定 常固体水素ペレット生成法として、クライオシリンダ方式 の固体水素生成法がある[40]. この方法では、予め固体水 素を冷却したクライオシリンダ内で生成しておき、必要に 応じてピストンで固体水素を押し出し・切断してペレット を形成するために、クライオシリンダの容量分のペレット を連続生成することが可能である.特に、ピストンの代わ りにスクリューを用いて固体水素を押し出す方式では、固 体水素の生成と同時にガスの供給が可能なため. 完全に定 常的な固体水素ペレットの生成が可能である[41,42].ペ レット加速方法としてはニューマチック加速方式と遠心加 速方式のいずれとも組み合わせることが可能である. ニューマチック方式は先に述べた通り信頼性の高い射出が 可能であるが、核融合炉への適用を想定すると、加速ガス 処理が短所となる、遠心加速方式は高速で回転する回転体 の遠心力を用いてペレットを加速する方式である[43].高 繰り返しで1.0 km/sのペレットを連続的に加速が可能であ り、加速ガスを必要としない点が核融合炉を想定した場合 の利点となっている.しかしながら,原理的に固体水素ペ

Lecture Note

レットと高速回転する機器との接触があるために、ペレットの損傷が避けられず、射出の信頼性がニューマチック加 速方式に比べて劣る.

∇B ドリフトによる粒子供給特性改善を期待して、トー ラス内側からのペレット入射を行う場合は、曲がったガイ ド管を利用してペレットをトーラス内側へ輸送する必要が あり、ガイド管内壁とペレットの接触に伴うペレットの破 損を避けるために、ペレット速度を抑制しなければならな い. 最大速度はガイド管途中にある屈曲部の半径等によっ て変わるが、おおよそ0.3-0.5 km/s 程度であり[44,45], 既存のペレット入射技術で到達可能なペレット速度よりも 遅いために、既存のペレット加速方法で対応可能である. 一方,核融合条件(大サイズ,高温)のプラズマでは、ペ レットの溶発位置が相対的に浅くなり、既存の技術で容易 に達成できる 1.0 km/s 程度のペレット入射速度では, プラ ズマ周辺部にしか粒子を供給できないため、燃焼プラズマ の維持に必要な粒子供給ができない可能性がある[1]. さ らに, 浅い侵入長に起因して, ∇B ドリフトによる粒子供 給特性改善だけでは十分な粒子供給ができない可能性も指 摘されている[46]. 高速ペレット入射の必要性は核融合研 究の初期から指摘されており、1980年代から高速ペレット 入射技術に関する研究が行われていたが, 前述の ∇B ドリ フトによる粒子供給特性改善の発見以降、技術開発のモチ ベーションは低下していた.しかしながら、核融合プラズ マへの粒子供給を想定すると、やはり既存の技術を超えた 高速ペレット入射が必要になるかもしれない. そのための 方策として実績があるペレット加速法は、2段ガスガン方 式である[47]. この加速原理はニューマチック加速を2段 にしたもので,まず,ニューマチック加速で駆動したピス トンでシリンダ内のガスを断熱圧縮して高温高圧の(すな わち, 音速が速い) ガスを生成し, 次に, その高温高圧の ガスを加速ガスとして用いてペレットを加速する.最大 4 km/s までの原理実証実験が行われた実績がある[48]. さらに速いペレット入射速度が必要な場合、革新的な加速 法が必要となる. その候補としては電磁飛翔体加速装置 (ElectroMagnetic Launcher; EML) のひとつであるレール ガンが挙げられる. レールガンはニューマチック加速のよ うに到達速度を制限する要素がないために高速射出の可能 性はあるものの、これまで実績がある速度は8 km/s程度で ある[49].また、これまで固体水素を加速した実績は無 く,加速時に働く応力による固体水素の破壊,レールの摩 擦によって生じる不純物のプラズマへの混入、繰り返し射 出特性、加速に要するエネルギー消費量など、明らかにし なければならないことが多く残されている.

6.5 まとめ

高温プラズマへの粒子供給をめざした固体水素ペレット 入射の素過程となる,『固体水素の溶発過程』と『溶発プ ラズモイドの均質化過程』について説明を行った.高温プ ラズマ中における固体水素ペレットの溶発現象では,プラ ズマからの熱流束を担う電子やイオンは溶発雲(ペレット が溶発して周囲に形成される中性ガス)との衝突により遮 蔽され,固体水素表面に到達エネルギーは非常に小さくな る.そのため,固化温度が~-260℃であり,昇華エネル ギーがきわめて小さいにもかかわらず,プラズマからの大 きな熱流束に曝されながらも,固体水素ペレットは比較的 長い寿命(~1 ms)を有する.そのため,高温プラズマ内 部へ侵入し,粒子を供給することが可能である.このよう に,高温プラズマ中の固体水素ペレット溶発挙動は中性ガ スによる遮蔽効果によって律速されている.さらに,溶発 雲はプラズマからの熱流束によってさらに加熱し続けら れ,高密度プラズモイドを形成し,閉じ込め磁場の影響を 強く受けながら背景プラズマに均質化していく点は磁場閉 じ込めプラズマによる固体水素ペレット溶発特有の現象と 思われる.

参考文献

- [1] R. Sakamoto *et al.*, Nucl. Fusion **52**, 083006 (2012).
- [2] M. Nishikawa et al., Fusion Eng. Des. 87, 466 (2012).
- [3] S.L. Milora, Nucl. Fusion 35, 657 (1995).
- [4] B. Pégourié, Plasma Phys. Control. Fusion 49, R87 (2007).
- [5] P.B. Parks and R.J. Turnbull, Phys. Fluids 21, 1735 (1978).
- [6] S.L. Milora and C.A. Foster, IEEE Transactions Plasma Sci. 6, 578 (1978).
- [7] W.A. Houlberg et al., Nucl. Fusion 32, 1951 (1992).
- [8] L.R. Baylor et al., Nucl. Fusion 37, 127 (1997).
- [9] Y. Nakamura et al., Nucl. Fusion 32, 2229 (1992).
- [10] B. Pégourié *et al.*, Plasma Phys. Control. Fusion 47, 17 (2005).
- [11] R. Sakamoto et al., Nucl. Fusion 41, 381 (2001).
- [12] M. Hoshino et al., Plasma Fusion Res. 1, 033 (2006).
- [13] Y. Nakamura et al., Nucl. Fusion 26, 907 (1986).
- [14] B.V. Kuteev et al., Nucl. Fusion 35, 1167 (1995).
- [15] L.R. Baylor et al., Nucl. Fusion 32, 2177 (1992).
- [16] P.T. Lang et al., Nucl. Fusion 36 1531 (1996).
- [17] P.T. Lang et al., Phys. Rev. Lett. 79, 1487 (1997).
- [18] L.R. Baylor et al., Fusion Technol. 34, 425 (1998).
- [19] J. de Kloe et al., Phys. Rev. Lett. 82, 2685 (1999).
- [20] L.R. Baylor et al., Phys. Plasmas 7, 1878 (2000).
- [21] JET Team, Nucl. Fusion 41, 1327 (2001).
- [22] L. Garzotti et al., Nucl. Fusion 50, 10 (2010).
- [23] V. Rozhansky *et al.*, Plasma Phys. Control. Fusion **37**, 399 (1995).
- [24] V.A. Rozhansky *et al.*, Plasma Phys. Control. Fusion 46, 575 (2004).
- [25] I. Yu. Senichenkov et al., Nucl. Fusion 46, 788 (2006).
- [26] B. Pégourié et al., Nucl. Fusion 47, 44 (2007).
- [27] F. Köchl, "Modelling of Transport and Pellet Fuelling in ITER-relevant Plasmas" 2008 *PhD Thesis, Vienna University of Technology.*
- [28] N. Commaux et al., Nucl. Fusion 50, 025011 (2010).
- [29] R. Sakamoto et al., Nucl. Fusion 53, 063007 (2013).
- [30] A. Matsuyama et al., Nucl. Fusion 52, 123017 (2012).
- [31] M. Goto et al., Phys. Plasmas 9, 4316 (2002).
- [32] T. Fujimoto, *Plasma Spectroscopy* (Oxford University Press, Oxford, 2004).
- [33] M. Goto et al., Plasma Phys. Control. Fusion 49, 1163 (2007).
- [34] C. Stehlé and R. Hutcheon, Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 140, 93 (1999).

- [35] A.W. Wishart, Mon. Not. R. Astron. Soc. 187, 59 (1979).
- [36] G. Motojima et al., Rev. Sci. Instrum. 83, 093506 (2012).
- [37] S.K. Combs, Rev. Sci. Instrum. 64, 1679 (1993).
- [38] J. Lafferranderie *et al.*, Proc. 14th Symposium on Fusion Technology **2**, 1367 (1986).
- [39] M. Hoshino et al., Fusion Eng. Des. 81, 2655 (2006).
- [40] S.K. Combs et al., Rev. Sci. Instrum. 56, 1173 (1985).
- [41] I. Viniar and S. V. Skoblikov, Instrum. Exp. Tech. 43, 722 (2000).
- [42] R. Sakamoto and H. Yamada, Plasma Fusion Res. 4, 002 (2009).



- [43] C. Andelfinger et al., Rev. Sci. Instrum. 64, 983 (1993).
- [44] S.K. Combs et al., Fusion Eng. Des. 58, 343 (2001).
- [45] S.K. Combs et al., Fusion Eng. Des. 75, 691 (2005).
- [46] B. Pégourié *et al.*, Plasma Phys. Control. Fusion **51**, 124023 (2009).
- [47] A. Reggiori et al., J. Vac. Sci. Technol. A 6, 2556 (1988).
- [48] P. Kupschus *et al.*, Proceedings of the 16th Symposium on Fusion Technology 1, 268 (1990).
- [49] A. Yamori, Bulletin of Institute of Space and Astronautical Science 117, 1 (2001).



構座レーザー生成プラズマの新しい温度,密度領域における物性とシミュレーション フレーザープラブフ相万作田にないて問題とたろ

7. レーザープラズマ相互作用において問題となる 物質状態に関する考え方のまとめ

7. Summary of New Modeling of Laser Plasma Interaction

米田仁紀 YONEDA Hitoki 電気通信大学レーザー新世代研究センター (原稿受付:2013年7月1日)

7.1 はじめに

本講座では、比較的低温かつ高密度な条件での物質状態 をシミュレーション上でどう取り扱うかについて、いくつ かのケースを紹介してきた。各章において「~はまだ合わ ない」「~は今後の問題である」という文言が散見するよう に、このパラメータ領域ではそれはまだ完全ではない。各 著者がそれぞれの分野において、うまくシミュレートでき るところとできないところを明確にしているので、そのあ たりを意識しながら読むと、より有益な情報が得られると 思う.

ある種のシミュレーションでは現象を計算機上で再現す ることが重要であって、物理が合っていることは二の次と なっている.低温で高密度という条件では、原子間力が強 く、電子 -電子相関が重要となり、それでいて原子は電子 励起状態にあることになるので、正確に解くのが困難であ る.第一原理的な計算も行われるが、通常の固体物理学で 使われている温度 T = 0の基底関数の組み合わせでは波動 関数を構成できなくなるので、膨大な計算時間が必要にな り、その結果、計算は粒子数などが限られた系でしか行わ れていない.

実験の精度が上がると、理論で用いられている物理モデ ルの検証がさらに進む.例えば、核融合研究や惑星科学の 研究で最も盛んに研究が行われている水素では、低温から 衝撃波圧縮を行った場合の50~100 GPaのあたりで分子の 解離やイオン化過程でもモデルが正確さを欠いていること などが最近問題となり、議論が続いている.d電子が物性 の主となる中Z原子(原子番号が中程度の原子)以上に関 しては、さらに複雑なため、詳細な議論はまだできていな い.

もちろん,これらはすべてマイナーな問題であり,入力条 件から計算された結果と実験観測のデータが近ければそれ でいいのだという考え方もある.しかし,物理を理解する 上では,まだまだ研究努力が必要で,そうでないと外挿し た状態がどうなるのか,予測の信頼性がなくなってしまう. このような観点から、この分野の研究をみる際には目的 を理解することが必要である.本講座の3~5章にまとめ られているように、EUV 発光応用やレーザー加工,超短パ ルスレーザーによる表面加工処理などの産業応用では、実 験現象の総合的な再現や、今後の条件最適化などに答えを 要求されていて、近いパラメータでの実験結果とシミュ レーションの結果を比較・検証してシミュレーションの妥 当性を確かめ、予測の信頼性を高めることが重要と考えら れている.

レーザーを使った実験ではポンププローブ計測が行われ ているが、高密度領域はプローブ光の波長を紫外にしても 臨界密度を超えていることもあり、いわゆる表面のみの観 測になっている.これを打開するためには、境界のない条 件を作って実験することもポイントであり、それが本講座 第6章で取り扱われた、keV プラズマ内に固体を打ち込ん だ状況になる.現在始められている X 線自由電子レーザー を用いた研究で、今後新たな結果が得られることが期待さ れている.

7.2 この領域の物性に関する問題

本講座の最初の章では、この領域のモデル化の難しさが 述べられている。その本質は、これまでの2つの物理モデ ル(固体物理学とプラズマ物理学)の条件が適合しないこ とにある。例えば、固体物理モデルでは、原子の秩序性を 無限長繰り返し、原子は電子的に基底状態にあることを仮 定している。したがって、金属であれば伝導帯中に電子が 共有され、自由電子様電子が光との相互作用で主となって いく、一方、プラズマモデルでは、完全イオン化、クーロ ン力が支配的になる状態で、デバイ遮蔽やプラズマ振動を 取り扱う。これらの中間状態では、3章で紹介されている ように双方の外挿をしてつなぎ合わせようとするが、場合 によっては外挿や重ね合わせが効かないことがモデル化と シミュレーションを困難にしている。

このような状況の中,大型計算機資源の助けもあって,

Institute for Laser Science (ILS), The University of Electro-Communications, Chofu, TOKYO 182-8585, Japan

author's e-mail: yoneda@ils.uec.ac.jp

低乙の純物質に関して精度の高い予測ができるようになっ てきた.本講座第2章では,量子効果を含んだ分子動力学 計算(QMD)が行われ,温度密度を決定すれば電子雲の特 徴的な形状やエネルギー状態を予測できるようになったこ とが紹介されている.QMD 計算で使われている方法にお いては,高密度のため2体ではなく多体の問題として解か なくてはならない状態を,Kohn-Sham 理論[1]により密度 汎関数を探し求め,置き換えるという密度汎関数理論が使 われている.これは,最近の固体物理学では,デスクトッ プの計算機で計算できるほど一般的になっている方法であ る.

しかし,低温かつ高密度の状態では,密度汎関数の答え を求める際に,基底状態の波動関数ではなく,隣接原子の 影響を受けた励起状態の波動関数の解を探しながら全体を 表記する密度汎関数を求めることになる. そのため, 繰り 返し計算が多くなり、計算量として膨大なものになってい る. それでも, 遷移金属より低い原子に関しては, Warm Dense Matter 領域の密度汎関数が求められるようになっ てきており、これは大きな進歩といえる. この汎関数が求 まっていれば,様々な自己相関関数をとることで輸送係数 や粘性などのマクロなパラメータを計算できるため、この パラメータ領域での現象予測にも有効な手段となってい る.本講座第2章の著者である More 氏らが提唱した高密 度プラズマの電気伝導度式(Lee-More model)は、この QMD 計算の修正を受け、低温・高密度領域まで拡張して 使えるようになった、それまで、電気伝導度はキャリア密 度とその速度の低下を生み出すエネルギー移行や散逸で十 分記述可能と思われてきたが、QMDの導入によって、一 つの電子でも局在化と非局在化の性質を時間を分けて取る ことが示され、伝導に関して新たな考えを必要とするス タートになった[2].

したがって、あらゆる物質と広いパラメータ領域で計算 機をフル活用して密度汎関数を求め、それらを元に、様々 な物性値をテーブル化し、シミュレーションコードがそれ を参照できるようになれば、非常に精度の高いシミュレー ションができることは間違いない.この講座の中で紹介さ れているシミュレーションでも、状態方程式や誘電率、導 電率、音速などのパラメータが、しばしば仮定を含んだり、 パラメータ的に外挿にあたる領域で使われているが、それ らは、このテーブルによりかなり大きく改善できるはず だ.しかし、残念ながらそうはなっていない.これは、依 然として以下の問題が残っているからだと思われる.

- (1) QMD計算では、現状では数百の原子数での計算に限られている。これは計算資源の問題である。1つの温度密度状態をスーパーコンピュータが数日かけて解く状態では、テーブル作成には膨大な時間がかかる。
- (2)通常,この原子間力が強く影響を及ぼす系では、これ までプラズマで当たり前のこととして使われてきた Sum rule が成り立たない場合が出てくる.ある種の化 学反応を起こす系で圧力-密度を論じるという状態に なり、化学ポテンシャルも温度密度で大きく変わるパ ラメータ領域が出てくるため、現実的な状況を計算す

るには、さらに膨大なデータベースが必要になる.

(3) 一様系では小さな体積でその境界を周期境界として計算をする手法が用いられるが、Warm Dense Matter 領域では気液混合状態のような非一様系も取り扱う必要がある.この場合、計算する系の大きさで非一様性度合いが制限されるので、一般化するには大きな系での計算も必要になり、それには長さの3乗で計算量が増えてしまって、現実的ではなくなる.

7.3 必要とされる新しい考え方

シミュレーションが現実をよく現すようになるのに伴っ て、内包される物理モデルの精度を上げていく必要があ る.1つのパラメータに複数の物理モデルが存在すること はざらにあるが、どのモデルが最も適切かを決定するに は、シミュレーションの精度だけでなく、検証のための実 験精度も向上させる必要がある.そのため、この領域で理 論予測物性値と実験値を合わせる場合の精度を、従来より も桁違いに改善する努力が行われている[3].

厳しい議論が行われている研究分野では,実験である程 度の範囲で検証されたモデルであっても,データの内挿部 分でしか使うことができず,外挿で予測することが困難な 場合も出てきている.前述の水素の状態方程式の問題で も,高圧方向では,爆弾を使った実験が最も高いマーカー となっているが,国によってはデータが参照できない場合 もある.

このように述べると、よほどの専門家でない限り議論に 参加できないように思えてしまうかもしれない.しかし, 定量性をあまり厳密に問わなければ、要素物理過程をわか りやすい形で入れた物理モデルを使うこともある. 例えば Murilloら[4]は、単純な一成分プラズマモデルを使っ て, 高密度化による一般のプラズマ物理からの変更点や, 何を求めればいいのかを紹介している.この中では、Poisson 方程式, Boltzmann 則から求められる Debye-Hückel モデルをもとに、ポテンシャル分布を一旦解き、そこから 求められる電子の存在確率分布を見直すことで、低温・高 密度状態のミクロスコピックな物理が明確にみえるように している.この存在確率関数は、そのまま解くと、原子間 距離が近くなってくると負になってしまう、実際には、イ オン半径程度で0になることが正しいと思われるので、補 正関数を導入して調整している.この関数にも、物理的な 描像が明らかな Pair correlation 関数, Direct correlation 関数, Bridge 関数を導入し計算することを提唱してい る. 例えば、常温・常圧での固体密度を保ったまま、アル ミニウムの温度を上昇させると, Friedel 振動と呼ばれる 現象が起きることがわかってきている[5].この現象は、 QMD の計算でも示されているが、前述の一成分モデルに おいても、各項の大きさを変えることで再現でき、どの要 素物理が効いているのかが明らかなようになっている.

また、この領域の状態では、ミクロスコピックな物理モ デルの精度を上げるために、原子間力、化学結合力、振動 エネルギー、電子運動エネルギーなどの要素を次々と入れ てモデルを構築しても、それとは別次元のメゾスコピック なスケールの特性が影響して、マクロなパラメータを決め てしまうことがある.このようなマルチスケールの現象を 考える上では、対象となる粒子の平均自由行程とその系の もつ特性長を比較することが重要になる.超短パルスレー ザーを用いて生成された Warm Dense Matter 実験などで は、密度の特性長より電子の平均自由行程が大きくなって しまうため、輸送現象を起こしているものが局所的なパラ メータでは決定できないこともありうる.本講座第4章で 取り上げられている不思議なレーザー痕も、冷却時や再付 着時の不安定性や音波などが影響していると考えられる が、表面波の影響を鑑みると、ビームスポットなどのもっ と大きな境界条件で決まっていることもあるだろう.

ミクロ-メゾ-マクロの問題は、物理学共通の問題であ る.プラズマは「高温」という特性により、観測しやすい 可視発光現象を伴うことが多く、原子物理的な考えもしや すい.一方、導電率は、レーザーの複素反射率などを計測 で置き換えることができ、様々なポンププローブ手法によ る実験を行えると考えられる.そのような観点から、相互 作用、状態方程式、輸送係数の依存性をもう一度見直して みると、さらに幅広い物理への展望が開けるのではない か.精度の高い理論、総合シミュレーションと実験の対比 が出てくれば、プラズマ研究がこの問題に一石を投じるこ とができると考えられる.

最後に、本講座第5章で議論されているような表面張 力、界面の問題は、まだ始まったところである.バルク対 表面の原子数を考えると、不純物が最も影響を与える場所 も表面であり、鉄系の高温状態では酸素含有量が0.1%で も表面張力が大きく変化する.これらをどう取り込んでい くかも、今後の問題となる.

7.4 まとめとして

以上, 講座の最後としては長いまとめとなった. 言い尽 くせないことがまだまだあるが, それらについては別の特 集や記事を参照してほしい. この第7章を頭に入れた上 で, この講座の記事を再度読んでいただくと, 興味がさら に増すだろうし, 自分が挑戦できそうな研究課題もみつか るはずだ. この講座が, 単にこれまで達成できた紹介だけ でなく新しい発展に結びついてくれたら, 記事の各著者に とっても喜びとなるだろう.

最後に,この章は,2013年6月にフランスで開かれた Warm Dense Matter に関する国際会議の現場で,最前線の 研究者の意見を聞いたうえで執筆した.その後を含め,国 際電話で長時間議論してくださった研究者の方々,講座の 執筆者の方々に,この場をお借りして感謝申し上げます.

参考文献

- [1] W. Kohn and L.J. Sham, Phys. Rev. 140, A 1133 (1965).
- [2] M.P. Desjarlais et al., Phys. Rev. E 66, 025401(R) (2002).
- [3] M.D. Knudson and M.P. Desjarlais, Phys. Rev. Lett. 103, 225501 (2009). M.D. Knudson, 18th Biennial Intl. Conference of the APS Topical Group on Shock Compression of Condensed Matter held in conjunction with the 24th Biennial Intl. Conference of the Intl. Association for the Advancement of High Pressure Science and Technology, 58, Number 7 (2013)
- [4] M.S. Murillo, Phys. Plasmas 11-5, 2964 (2004).
- [5] D. Saumon et al., High Energy Density Phys. 8, 150 (2012).



お田仁紀

電気通信大学レーザー新世代研究センター 教授,センター長,工学博士.レーザーと 物質との相互作用研究を中心に,超短パル スレーザーからX線に至るまでの実験研究

を行っている.特に,最近では新しくできた X 線自由電子 レーザーを用いた物理研究を中心に基礎研究を行っている. これまでにパルスパワー技術,大口径エキシマレーザー開発 などからダイヤモンド薄膜を用いた超高速高出力素子の開 発,超高品質光学素子の精密計測など,レーザー科学や, Warm dense matter,プラズマフォトニクス,大型レーザー による超強磁場発生実験,EUV,X線レーザーを用いた非線 形光学などの高エネルギー密度科学に関わる幅広い研究を 行っている.教育面では学生に危機・限界を体験させるプロ グラムを開発し,実践力をつけさせる若手育成なども行って いる.